1. **Kikuo Tominaga, Hidenori Fukumoto, Kumiko Kondo, Yukako Hayashi, Kei-ichiro Murai, Toshihiro Moriga *and* Ichiro Nakabayashi :** Al-impurity-doped Transparent Conductive Oxide Films of In2O3-ZnO System, *Vacuum,* **Vol.74,** *No.3-4,* 683-687, 2004.
2. **Kaoru Ohya, Yoshihiko Nakayama, Yoshitaka Hamada, Tetsuo Tanabe, Andreas Kirschner, Volker Philipps *and* Nobuaki Noda :** Modeling of Material Mixing Effects on Plasma Surface Interactions in Magnetic Fusion Devices, *Physica Scripta,* **Vol.T111,** 138-144, 2004.
3. **Kazuya Kusaka, Takao Hanabusa *and* Kikuo Tominaga :** Measurement of crystal orientation and residual stress in GaN film deposited by RF sputtering with powder target, *Vacuum,* **Vol.74,** *No.3-4,* 613-618, 2004.
4. **Tao Wang, J P Parbrook, N C Harrison, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Highly improved performance of a 350nm ultraviolet light-emitting diode containing AlxGa1-xN/AlyGa1-yN distributed Bragg reflectors, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.267,** *No.3-4,* 583-587, 2004.
5. **Retsuo Kawakami, Tomohisa Shimada, Yoshio Ueda *and* Masahiro Nishikawa :** Simulation Study of Dynamical Material Mixing on Tungsten Surfaces at Elevated Temperatures due to Hydrogen and Carbon Mixed Ion Beam Irradiation, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.329-333,** *No.0,* 737-741, 2004.
6. **Takenori Mitani, Retsuo Kawakami *and* Shuhei Kuriu :** Simulation Study of Sputtering Erosion and Impurity Deposition on Carbon and Tungsten Surfaces Irradiated with Deuterium Plasmas Including Carbon Impurity, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.329,** *No.329-333,* 830-835, 2004.
7. **Yoshio Ueda, Takahisa Funabiki, Tomohisa Shimada, Retsuo Kawakami *and* Masahiro Nishikawa :** Effects of Carbon Impurity in Fusion Plasmas on Erosion of RAF First Wall, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.329-333,** 771-774, 2004.
8. **Tomohisa Shimada, Takahisa Funabiki, Retsuo Kawakami, Yoshio Ueda *and* Masahiro Nishikawa :** Carbon Behavior on Tungsten Surface after Carbon and Hydrogen Mixed Beam Irradiation, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.329-333,** *No.0,* 747-751, 2004.
9. **Kazuhito Tajima, Shigeru Nakamura, Furukawa A. *and* Sasaki T. :** Hybrid-integrated Symmetric Mach-Zehnder all-optical switches and ultrafast signal processing, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.87,** *No.7,* 1119-1125, 2004.
10. **Yu-Huai Liu, Hong-Dong Li, Jin-Ping Ao, Young-Bae Lee, Tao Wang *and* Shiro Sakai :** Influence of undoped GaN layer thickness to the performance of AlGaN/GaN-based ultraviolet light-emitting diodes, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.268,** *No.1-2,* 30-34, 2004.
11. **Kazuya Kusaka, Takao Hanabusa, Kikuo Tominaga *and* Noriyoshi Yamauchi :** Effect of Substrate Temperature on Crystal Orientation and Residual Stress in Radio Frequency Sputtered Gallium-Nitride Films, *Journal of Vacuum Science & Technology A,* **Vol.22,** *No.4,* 1587-1590, 2004.
12. **Toshihiro Moriga, Yukako Hayashi, Kumiko Kondo, Yusuke Nishimura, Kei-ichiro Murai, Ichiro Nakabayashi, Hidenori Fukumoto *and* Kikuo Tominaga :** Transparent Conducting Amorphous Zn-Sn-O Films Deposited by Simultaneous DC Sputtering, *Journal of Vacuum Science & Technology A,* **Vol.22,** *No.4,* 1705-1710, 2004.
13. **Kaoru Ohya *and* Tohru Ishitani :** Monte Carlo simulation of topographic contrast in scanning ion microscope, *Journal of Electron Microscopy,* **Vol.53,** *No.3,* 229-235, 2004.
14. **Fawang Yan, Masashi Tsukihara, Akihiro Nakamura, Takayuki Yadani, Tetsuya Fukumoto, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Surface smoothing mechanism of AlN film by initially alternating supply of ammonia, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 2 (Letters),* **Vol.43,** *No.8B,* L1057-L1059, 2004.
15. **Yoshitaka Hamada, Shinji Ebisu *and* Kaoru Ohya :** Transition Behaviour between Erosion and Deposition on a Tungsten Surface Exposed to Deuterium Plasmas Containing Carbon Impurities, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.43,** *No.9A,* 6385-6391, 2004.
16. **Kaoru Ohya, Tetsuo Tanabe, Marek Rubel, Motoi Wada, Tadashi Ohgo, Takeshi Hirai, Volker Philipps, Andreas Kirschner, Albrecht Pospieszczyk, Alexander Huber, Genadij Sergienko, S. Brezinsek *and* Nobuaki Noda :** Modeling of erosion and deposition patterns on C-W and W-Ta twin limiters exposed to the TEXTOR edge plasmas, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.329-333,** *No.Part A,* 732-736, 2004.
17. **Kaoru Ohya *and* Tohru Ishitani :** Monte Carlo study of secondary electron emission from SiO2 induced by focused gallium ion beams, *Applied Surface Science,* **Vol.237,** *No.1-4,* 602-606, 2004.
18. **Kazuya Kusaka, Takao Hanabusa, Kikuo Tominaga *and* Noriyoshi Yamauchi :** Effect of substrate temperature on crystal orientation and residual stress in RF sputtered galium nitride films, *Materials Science Forum,* **Vol.490-491,** 613-618, 2005.
19. **Mitsuhiko Hataya, Takao Hanabusa, Kazuya Kusaka, Kikuo Tominaga *and* Tatsuya Matsue :** Residual stress measurement in sputtered copper thin films by synchrotron radiation and ordinary X-rays, *Materials Science Forum,* **Vol.490-491,** 661-668, 2005.
20. **Retsuo Kawakami :** Simulation Study on Influence of Chemically Eroded Carbon Impurity Transport on Net Sputtering Erosion of Carbon Materials Exposed to Edge Fusion Plasmas, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.44,** *No.2,* 1069-1075, 2005.
21. **森賀 俊広, 林 由佳子, 三河 通男, 村井 啓一郎, 富永 喜久雄 :** 第3世代透明導電性アモルファス薄膜の創製, *徳島大学工学部研究報告, No.50,* 7-12, 2005年.
22. **Kazuhiro Nishizono, Masaya Okada, Minoru Kamei, Daigo Kikuta, Kikuo Tominaga, Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** Metal/Al-doped ZnO ohmic contact for AlGaN/GaN high electron mobility transistor, *Applied Physics Letters,* **Vol.84,** *No.20,* 3996-3998, 2004.
23. **Naotaka Kubota, Jin-Ping Ao, Daigo Kikuta *and* Yasuo Ohno :** Schottky Barrier Height Determination by Capacitance-Voltage Measurement on n-GaN with Exponential Doping Profile, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.43,** *No.7A,* 4159-4160, 2004.
24. **Tohru Ishitani *and* Kaoru Ohya :** Comparative study of scanning ion microscope and scanning electron microscope images using Monte Carlo simulations, *Microscopy and Microanalysis,* **Vol.10,** *No.Suppl 02,* 140-141, 2004.
25. **川上 烈生, 山上 喜廣, 富永 喜久雄, 服部 敦美, 來山 征士, 大野 泰夫 :** デジタル化・ネットワーク化時代の電気電子工学学生実験, *徳島大学高度情報化基盤センター「広報」,* **Vol.12,** 57-60, 2005年2月.
26. **Retsuo Kawakami *and* Mitani Takenori :** Simulation Study on Influence of Chemically Eroded Higher Hydrocarbons on SOL Impurity Transport and Effect of Dynamical Material Mixing on Erosion/Deposition of Tungsten Surfaces Exposed to Plasma Boundary, *16th International Conference on Plasma Surface interactions in Controlled Fusion Devices,* P1-29, Portland Maine, U.S.A., May 2004.
27. **Kazuya Kusaka, Takao Hanabusa, Kikuo Tominaga *and* Noriyoshi Yamauchi :** Effect of Substrate Temperature on Crystal Orientation and Residual Stress in RF Sputtered Gallium Nitride Films, *Proceedings of the 7th International Conference on Residual Stresses,* 613-618, Xi'an, Jun. 2004.
28. **Mitsuhiko Hataya, Takao Hanabusa, Kazuya Kusaka, Kikuo Tominaga, Tatsuya Matsue *and* Osami Sakata :** Residual Stress Measurement in Sputtered Copper Thin Films by Synchrotron Radiation and Ordinary X-rays, *Proceedings of the 7th International Conference on Residual Stresses,* 661-666, Xi'an, Jun. 2004.
29. **Daigo Kikuta, Ryohei Takaki, Junya Matsuda, Masaya Okada, Xin Wei, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Gate Leakage Reduction Mechanism of AlGaN/GaN MIS-HFETs, *2004 International Conference on Solid State Devices and Materials,* Tokyo, Sep. 2004.
30. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai *and* Ishitani Tohru :** Reconstruction of pseudo secondary electron images in scanning ion microscope, *15th International Workshop on Inelastic Ion Surface Collisions,* Mie, Japan, Oct. 2004.
31. **Michio Mikawa, Toshihiro Moriga, Yuji Sakakibara, Yukinori Misaki, Kei-ichiro Murai, Ichiro Nakabayashi *and* Kikuo Tominaga :** Preparation of ZnO-In2O3 transparent conducting films by pulsed laser depositon, *11th International Workshop on Oxide Electronics,* Hakone, Oct. 2004.
32. **Toshihiro Moriga, Michio Mikawa, Yuji Sakakibara, Yukinori Misaki, Kei-ichiro Murai, Ichiro Nakabayashi *and* Kikuo Tominaga :** Effects of introduction of argon on structural and transparent conducting properties of ZnO-In2O3 thin films prepared by pulsed laser deposition, *11th International Workshop on Oxide Electronics,* Hakone, Oct. 2004.
33. **Retsuo Kawakami :** Simulation Study on Effects of Chemically Eroded Methane and Ethylene Molecules on Carbon Impurity Transport and Net Erosion of Carbon Materials, *Joint Meeting of 14th Internaitional Toki Conference on Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion & 4th International Conference on Atomic and Molecular Data and Their Application,* 73, Toki, Oct. 2004.
34. **Yukako Hayashi, Kumiko Kondo, Yusuke Nishimura, Hiroshi Suketa, Kei-ichiro Murai, Toshihiro Moriga, Ichiro Nakabayashi *and* Kikuo Tominaga :** Characterizations of Transparent Conducting Amorphous ZnO-SnO2 Films Deposited by Opposed Target Sputtering System, *The 13th International Conference on Processing and Fabrication of Advanced Materials,* **Vol.1,** 209-218, Singapore, Dec. 2004.
35. **旗谷 充彦, 野田 和宏, 日下 一也, 富永 喜久雄, 英 崇夫, 松英 達也, 坂田 修身 :** ナノサイズCu薄膜の残留応力測定, *日本材料学会四国支部第5期総会·学術講演会講演論文集,* 5-6, 2004年4月.
36. **高木 亮平, 岡田 政也, 菊田 大悟, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETのサイドゲート効果における光の影響, *日本物理学会中四国支部，応用物理学会中四国支部，物理教育学会四国支部連絡協議会2004年度支部学術講演会,* 2004年7月.
37. **林 由佳子, 西村 勇介, 助田 祐志, 近藤 久美子, 森賀 俊広, 村井 啓一郎, 中林 一朗, 富永 喜久雄 :** ZnO-In2O3系アモルファス透明導電膜の評価, *第65回日本応用物理学会学術講演会,* 2004年9月.
38. **岡田 政也, 高木 亮平, 菊田 大悟, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET 電流電圧特性における光応答, *第65回応用物理学会学術講演会,* 2004年9月.
39. **川上 烈生 :** SOLプラズマ中の炭素不純物輸送への高次炭化水素CxDyの寄与, *平成16年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 39, 2004年9月.
40. **上田 良夫, 崎園 大, 沢村 功, 島田 朋尚, 川上 烈生, 西川 雅弘 :** タングステン第一壁上の炭素混合層の形成メカニズム, *プラズマ核融合学会 第20回年会 講演論文集,* 2004年11月.
41. **川上 烈生 :** プラズマ対向壁としての低放射化フェライト鋼F82Hの損耗特性, *平成17年電気学会全国大会講演論文集,* 222, 2005年3月.
42. **山上 喜廣, 川上 烈生, 富永 喜久雄, 岩崎 聡一郎, 松田 潤也 :** 電気回路の過渡現象に関する創成型学生実験への取り組みとその教育効果, *平成17年電気学会全国大会講演論文集,* 1, 2005年3月.
43. **富永 喜久雄, 林 由佳子, 森賀 俊広, 中林 一朗 :** ZnO-SnO2, ZnO-In2O3透明導電膜の作製と評価, *平成17年電気学会全国大会講演論文集,* **Vol.3,** 3-S19(1)-3-S19(2), 2005年3月.
44. **西村 勇介, 助田 祐志, 林 由佳子, 村井 啓一郎, 森賀 俊広, 中林 一朗, 富永 喜久雄 :** ZnO-SnO2系アモルファス透明導電膜へのAl，Gaドーピングの影響, *第52回応用物理学関連連合講演会,* 2005年3月.
45. **高木 亮平, 岡田 政也, 菊田 大悟, 敖 金平, 大野 泰夫 :** 熱酸化によるAlGaN/GaN MIS-HFETゲート電流の低減, *第52回応用物理学関係連合講演会,* 2005年3月.
46. **岡田 政也, 高木 亮平, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETしきい値電圧の温度及び光照射依存性, *第52回応用物理学関係連合講演会,* 2005年3月.
47. **川上 烈生 :** デタッチプラズマ照射下の炭素材から放出された炭素不純物の振舞いに関する研究, *平成16年度核融合科学研究所LHD数値解析システム利用共同研究報告書,* 日本, 2005年3月.
48. **富永 喜久雄 :** (共著)脱ITOに向けた透明導電膜の低抵抗・低温・大面積製膜技術, 株式会社 技術情報協会, 東京, 2005年7月.
49. **酒井 士郎, 高橋 清, 他 :** ワイドギャップ半導体光・電子デバイス, 森北出版 株式会社, 東京, 2006年2月.
50. **Kaoru Ohya, Tetsuo Tanabe, Andreas Kirschner, Takeshi Hirai, Volker Philipps, Motoi Wada, Tadashi Ohgo *and* Nobuaki Noda :** Dynamic transition between erosion and deposition on a tungsten surface exposed to edge plasmas containing carbon impurities, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.337-339,** 882-886, 2005.
51. **Retsuo Kawakami *and* Mitani Takenori :** Simulation Study on Influence of Chemically Eroded Higher Hydrocarbons on SOL Impurity Transport and Effect of Dynamical Material Mixing on Erosion/Deposition of Tungsten Surfaces Exposed to Plasma Boundary, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.337-339,** 45-49, 2005.
52. **Tao Wang, G Raviprakash, F Ranalli, N C Harrison, Jie Bai, R J P David, J P Parbrook, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Effect of Strain Relaxation and Exciton Localization on Performance of 350-nm AlInGaN Quantum Light-Emitting Diodes, *Journal of Applied Physics,* **Vol.97,** *No.8,* 083104-1-083104-4, 2005.
53. **Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Evaluation of Surface States of AlGaN/GaN HFET Using Open-Gated Structure, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E88-C,** *No.4,* 683-689, 2005.
54. **Daigo Kikuta, Ryohei Takaki, Junya Matsuda, Masaya Okada, Xin Wei, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Gate Leakage Reduction Mechanism of AlGaN/GaN MIS-HFETs, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.44,** *No.4B,* 2479-2482, 2005.
55. **Kikuo Tominaga, Hidenori Fukumoto, Kumiko Kondo, Yukako Hayashi, Kei-ichiro Murai, Toshihiro Moriga *and* Ichiro Nakabayashi :** Amorphous Transparent Conductive Oxide Films of In2O3-ZnO with Additional Al2O3 Impurities, *Journal of Vacuum Science & Technology A,* **Vol.23,** *No.3,* 401-407, 2005.
56. **R.J. Choi, S. Kubo, M. Tsukihara, K. Inoue, Yoshiki Naoi, Katsushi Nishino *and* Shiro Sakai :** Effects of V/III flux ratio on AlInGaN/AlGaN quantum wells grown by atmospheric pressure MOCVD, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.2,** *No.7,* 2149-2152, 2005.
57. **Michio Mikawa, Toshihiro Moriga, Yuji Sakakibara, Yukinori Misaki, Kei-ichiro Murai, Ichiro Nakabayashi *and* Kikuo Tominaga :** Characterization of ZnO-In2O3 transparent conducting films by pulsed laser deposition, *Materials Research Bulletin,* **Vol.40,** *No.6,* 1052-1058, 2005.
58. **Fawang Yan, Yoshiki Naoi, Masashi Tsukihara, Takayuki Yadani *and* Shiro Sakai :** Interdiffusion induced In(Ga)NAs films growth on GaAs substrates by low-pressure metalorganic chemical vapor deposition, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.282,** *No.1-2,* 29-35, 2005.
59. **Toshihiro Moriga, Michio Mikawa, Yuji Sakakibara, Yukinori Misaki, Kei-ichiro Murai, Ichiro Nakabayashi *and* Kikuo Tominaga :** Effects of introduction of argon on structural and transparent conducting properties of ZnO-In2O3 thin films prepared by pulsed laser deposition, *Thin Solid Films,* **Vol.486,** *No.1,* 53-57, 2005.
60. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Dynamic Monte Carlo Simulation of Compositional and Topography Changes Induced by Ion Beam Irradiation, *e-Journal of Surface Science and Nanotechnology,* **Vol.4,** 32-38, 2006.
61. **Retsuo Kawakami, Tomohisa Shimada, Yoshio Ueda *and* Masahiro Nishikawa :** Influence of Carbon Impurity on Net Erosion of Reduced-Activation Ferritic/Martensitic Steel and Tungsten Materials Exposed to Hydrogen and Carbon Mixed Ion Beam Relevant to Fusion Plasma Boundary, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.45,** *No.1A,* 221-227, 2006.
62. **Takashi Okimoto, Masashi Tsukihara, Kazuhide Sumiyoshi, Ken Kataoka, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Effect of GaNP Buffer Layer on AlGaN Epilayers Deposited on (0001) Sapphire Substrates by Metalorganic Chemical Vapor Deposition, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 2 (Letters),* **Vol.45,** *No.8,* L236-L238, 2006.
63. **Kaoru Ohya, Tetsuo Tanabe *and* Jun Kawata :** Simulation of redeposition patterns of hydrocarbons released from carbon target in divertors, *Fusion Engineering and Design,* **Vol.81,** *No.1-7,* 205-210, 2006.
64. **Shinji Ebisu, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Dynamic erosion and deposition on carbon and tungsten sue to simultaneous bombardment with deuterium and beryllium ions in plasmas, *Fusion Engineering and Design,* **Vol.81,** *No.1-7,* 253-258, 2006.
65. **Retsuo Kawakami :** Simulation Study on Effects of Chemically Eroded Methane and Ethylene Molecules on Carbon Impurity Transport and Net Erosion of Carbon Materials, *Journal of Plasma and Fusion Research SERIES,* **Vol.7,** 94-97, 2006.
66. **Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Gate leakage and electrical performance of AlGaN/GaN MIS-type HFET with evaporated silicon oxide layer, *Solid-State Electronics,* **Vol.50,** *No.3,* 316-321, 2006.
67. **Yoshiki Naoi, Hisao Sato, Hiroshi Yamamoto, Kodai Ono, Akihiro Nakamura, Masahiro Kimura, Suguru Nouda *and* Shiro Sakai :** Growth and fabrication of AlGaInN-based UV-LEDs using SiN nano-mask, *Proceedings of SPIE,* **Vol.5722,** 417-422, San Jose, Apr. 2005.
68. **Retsuo Kawakami :** Simulation study of carbon impurity dynamics on reduced-activation ferritic/martensitic steel material at elevated temperatures under hydrogen exposure, *7th International Symposium on Fusion Nuclear Technology,* 191, Tokyo, May 2005.
69. **Fawang Yan, Yoshiki Naoi, Masashi Tsukihara, Shuichi Kawamichi, Takayuki Yadani *and* Shiro Sakai :** Diffusion Effect Induced InAsN Films Growth on GaAs(100) Substrates by MOCVD, *The 23rd International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS-23),* TuP.79, Higashiura, Jul. 2005.
70. **Toshihiro Moriga, Yusuke Nishimura, Hiroshi Suketa, Kei-ichiro Murai, Kikuo Tominaga *and* Ichiro Nakabayashi :** Effects of Al, Ga -Doping on Transparent Conducting Properties of Amorphous ZnO -SnO2 Films, *Advanced Materials Development & Performance Conference 2005,* Auckland, Jul. 2005.
71. **Masaya Okada, Ryohei Takaki, Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Temperature and Illumination Dependence of AlGaN/GaN HFET Threshold Voltage, *2005 Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Hyogo, Aug. 2005.
72. **Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao, Junya Matsuda *and* Yasuo Ohno :** A Mechanism of Enhancement-mode Operation of AlGaN/GaN MIS-HFET, *2005 Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Hyogo, Aug. 2005.
73. **Yoshiki Naoi, Akihiro Nakamura, Kodai Ono, Hisao Sato, H Yamamoto, M Mikura, Suguru Nouda *and* Shiro Sakai :** Impurity induced disordering of p-type AlGaN-GaN Superlat-tice Structures, *6th International Conference on Nitride Semiconductors,* Th-P-023, Bremen, Aug. 2005.
74. **Kazuhide Sumiyoshi, Masashi Tsukihara, Fawang Yan *and* Shiro Sakai :** AlGaN Films grown on trenched sapphire substrates using a low-temperature GaNP buffer layer by MOCVD, *6th international conference on nitride semiconductors,* Tu-P-089, Bremen, Germany, Aug. 2005.
75. **Jin-Ping Ao, Ryota Kan, Toshio Hirao, Hideki Okada, Masaya Okada, Daigo Kikuta, Shinobu Onoda, Hisayoshi Itoh *and* Yasuo Ohno :** Gamma Radiation Effects on the Ohmic Contact of AlGaN/GaN HEMTs, *2005 International Conference on Solid State Devices and Materials,* 478-479, Kobe, Sep. 2005.
76. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Dynamic Monte Carlo simulation of Compositional and Topography Changes Induced by Ion Beam irradiation, *International Symposium on Surface Science and Nanotechnology,* Saitama, Japan, Nov. 2005.
77. **Kaoru Ohya *and* Kensuke Inai :** Simulation of redeposition patterns in the gaps between divertor tiles, *12th International Conference on Fusion Reactor Materials,* California, USA, Nov. 2005.
78. **Y Sumiyoshi, Masashi Tsukihara, Ken Kataoka, Kiyoshi Okimoto, Shuichi Kawamichi, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** High-quality AlGaN film grown on the patterned sapphire substrate using a low-temperature intermediate layer by MOCVD, *International COE Workshop on Nano Processes and Devices, and Their Applications,* 75-76, Nagoya University, Dec. 2005.
79. **榊原 友士, 高田 望美, 三河 通男, 村井 啓一郎, 森賀 俊広, 中林 一朗, 富永 喜久雄 :** PLD法によるサファイア基板上へのZnO-In2O3系透明導電膜の作製と評価, *第52回応用物理学関連連合講演会,* 2005年4月.
80. **菊田 大悟, 敖 金平, 松田 潤也, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN MIS-HFET のエンハンスメント動作, *第52回応用物理学関係連合講演会,* 2005年4月.
81. **助田 祐志, 西村 勇介, 高田 大輔, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** ポリカーボネート基板上に作製したZnO-In2O3系 アモルファス透明導電膜, *日本物理学会中国支部·四国支部 応用物理学会中国四国支部 2005年度支部学術講演会,* 2005年7月.
82. **川上 烈生 :** 炭素不純物を含む水素イオンで照射されたタングステン材表面の付着炭素不純物の振舞い, *第66回秋季応用物理学会学術講演会論文集, No.2,* 630, 2005年9月.
83. **月原 政志, 住吉 和英, 閻 発旺, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 高品質AlGaNへ向けての低温成長AlGaN層の検討, *第66回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* 274, 2005年9月.
84. **直井 美貴, 中村 晃啓, 小野 耕大, 酒井 士郎, 木村 真大, 納田 卓 :** p-AlGaN/GaN 超格子構造における不純物ドーピングによる混晶化, *第66回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* 279, 2005年9月.
85. **住吉 和英, 月原 政志, 河道 修一, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 低温GaNPバッファー層を用いた加工サファイア基板上のAlGaN MOCVD成長, *第66回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* 269, 2005年9月.
86. **閻 発旺, 住吉 和英, 月原 政志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** MOCVD法によるサファイア基板上へのSb添加AlNの成長, *第66回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* 269, 2005年9月.
87. **菅 良太, 平尾 敏雄, 小野田 忍, 伊藤 久義, 岡田 英輝, 岡田 政也, 菊田 大悟, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET電気特性へγ線照射の影響, *第66回応用物理学会学術講演会,* 2005年9月.
88. **松田 潤也, 菊田 大悟, 敖 金平, 大野 泰夫 :** 周波数可変カーブトレーサを用いたAlGaN/GaN MIS-HFETヒステリシスの解析, *第66回応用物理学会学術講演会,* 2005年9月.
89. **榊原 友士, 石田 勝也, 三河 通男, 村井 啓一郎, 森賀 俊広, 富永 喜久雄 :** PLD法によりc-サファイア基板上に作製したZnO-In2O3系透明導電膜の評価, *第66回応用物理学会学術講演会,* 2005年9月.
90. **三河 通男, 榊原 友士, 石田 勝也, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** PLD法により作製したZnO-In2O3系透明導電膜の構造·特性に及ぼす基板の影響, *第66回応用物理学会学術講演会,* 2005年9月.
91. **高田 大輔, 富永 喜久雄, 西村 勇介, 助田 祐志, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** Al2O3不純物添加 アモルファスZnO-In2O3系透明導電膜の特性, *第66回応用物理学会学術講演会,* 2005年9月.
92. **山本 真美子, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** フラックス法によるBP結晶成長, *電気関係学会四国支部連合大会,* 151, 2005年9月.
93. **河道 修一, 住吉 和英, 月原 政志, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 加工サファイア上に成長したAl0.07Ga0.93N薄膜の透過型電子顕微鏡による評価, *電気関係学会四国支部連合大会,* 150, 2005年9月.
94. **沖本 聖, 月原 政志, 住吉 和英, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** AlGaN-MOCVD成長における GaNPバッファ層の効果, *電気関係学会四国支部連合大会,* 149, 2005年9月.
95. **松田 義和, 菅 良太, 山岡 優哉, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET構造を用いたショットキーダイオード, *平成17年度電気関係学会四国支部連合大会,* 2005年9月.
96. **川上 烈生 :** 非平衡プラズマの自己組織化とドライエッチングとの関連性, *平成17年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 36, 2005年9月.
97. **住吉 和英, 酒井 士郎, 直井 美貴, 西野 克志 :** 窒化物半導体と紫外発光デバイス, *第7回IEEE広島支部学生シンポジウム(HISS),* 2005年11月.
98. **山本 真美子, 月原 政志, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** フラックス成長BP結晶上へのGaN成長, *第53回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* **Vol.22,** 346, 2006年3月.
99. **住吉 和英, 月原 政志, 沖本 聖, 河道 修一, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 低温中間層を用いた加工サファイア基板上のAl0.17Ga0.83N MOCVD成長, *第53回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* **Vol.25,** 378, 2006年3月.
100. **河道 修一, 西野 克志, 住吉 和英, 月原 政志, 酒井 士郎 :** 凹凸サファイア基板上に成長させたAlGaN薄膜の反転ドメイン, *第53回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* **Vol.25,** 379, 2006年3月.
101. **池田 賢司, Choi Rak-Jun, 福本 哲也, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎, Lee Min Soo, 小池 正好 :** AlInN-buffer層上のALEによるa面GaNの高品質化, *第53回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* **Vol.26,** 401, 2006年3月.
102. **石田 勝也, 榊原 友士, 三河 通男, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** PLD法により作製したZnO-In2O3系二層膜の特性評価, *第53回応用物理学関係連合講演会,* 2006年3月.
103. **助田 祐志, 西村 勇介, 瀧田 啓介, 高田 大輔, 下村 幸司, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** ZnO-In2O3系透明導電膜における特性のGa2O3ドーパントの添加量依存性, *第53回応用物理学関連連合講演会,* 2006年3月.
104. **松浦 一暁, 菊田 大悟, 敖 金平, 扇谷 浩通, 平本 道広, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** SiCl4ガスを用いたICP-RIEによるAlGaN/GaN HFETのゲートリセスエッチング, *第53回応用物理学関係連合講演会,* 2006年3月.
105. **敖 金平, 長岡 史郎, 岩崎 聡一郎, 岡田 政也, 大巻 雄治, 大野 泰夫 :** EB露光CuゲートAlGaN/GaN HFETの高周波特性, *第53回応用物理学関係連合講演会,* 2006年3月.
106. **川上 烈生 :** SOLプラズマ中の炭素不純物によるタングステン材表面の損耗変化に関する研究, *平成17年度核融合科学研究所LHD数値解析システム利用共同研究報告書,* 日本, 2006年3月.
107. **富永 喜久雄 :** ZnO系の最新技術と応用, 株式会社 シーエムシー出版, 東京, 2007年1月.
108. **Shiro Sakai, Kiyoshi Takahash *and* al. et :** Wide Bandgap Semiconductors, Nippon Gakujyutsu-shinnkoukai, Feb. 2007.
109. **Kikuo Tominaga, Ito Daisuke *and* Miyamoto Yoshinori :** Energetic negative ions in titanium oxide deposition by reactive sputtering in Ar/O2, *Vacuum,* **Vol.80,** 654-657, 2006.
110. **Retsuo Kawakami :** Simulation study of carbon impurity dynamics on reduced-activation ferritic/martensitic steel material at elevated temperatures under hydrogen exposure, *Fusion Engineering and Design,* **Vol.81,** *No.8-14,* 1683-1687, 2006.
111. **Masaya Okada, Ryohei Takaki, Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Temperature and Illumination Dependence of AlGaN/GaN HFET Threshold Voltage, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E89-C,** *No.7,* 1042-1046, 2006.
112. **Daigo KIKUTA, Jin-Ping Ao, Junya MATSUDA *and* Yasuo Ohno :** A Mechanism of Enhancement-mode Operation of AlGaN/GaN MIS-HFET, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E89-C,** *No.7,* 1031-1036, 2006.
113. **Kaoru Ohya :** Dynamic simulation of erosion and redeposition on plasma-facing materials, *Physica Scripta,* **Vol.T124,** 70-75, 2006.
114. **F.W. Yan, Yoshiki Naoi, M. Tsukihara, S. Kawamichi, T. Yadani, K. Sumiyoshi *and* Shiro Sakai :** Diffusion effect-induced InNAs films growth on GaAs(100) substrates by MOCVD, *Physica B : Condensed Matter,* **Vol.376-377,** 595-597, 2006.
115. **Retsuo Kawakami :** Simulation Study of Carbon Impurity Dynamics on Tungsten Surfaces Exposed to Hydrogen Ions, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.348,** 256-262, 2006.
116. **Toshihiro Moriga, Yusuke Nishimura, Hiroshi Suketa, Kei-ichiro Murai, Kazuhiro Nogami, Kikuo Tominaga *and* Ichiro Nakabayashi :** Effects of Al, Ga-Doping on Transparent Conducting Properties of Amorphous ZnO-SnO2 Films, *International Journal of Modern Physics B,* **Vol.20,** *No.25-27,* 3902-3907, 2006.
117. **Shuichi Kawamichi, Katsushi Nishino, Kazuhide Sumiyoshi, Masashi Tsukihara, Fanwang Yan *and* Shiro Sakai :** Inversion domain in AlGaN films grown on patterned sapphire substrate, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.298,** 297-299, 2007.
118. **Katsushi Nishino, A. Sakamoto *and* Shiro Sakai :** Growth of thich a-plane GaN on r-plane sapphire by direct synthesis method, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.4,** *No.7,* 2532-2535, 2007.
119. **Kazuhide Sumiyoshi, Masashi Tsukihara, Ken Kataoka, Shuichi Kawamichi, Tadashi Okimoto, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Al0.17Ga0.83N film with Middle Temperature Intermediate Layer Grown on Trenched Sapphire Substrate by MOCVD, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.298,** *No.SI,* 300-304, 2007.
120. **K. Sumiyoshi, M. Tsukihara, K. Kataoka, S. Kawamichi, T. Okimoto, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Al0.17Ga0.83N Film Using Middle-Temperature Intermediate Layer Grown on (0001) Sapphire Substrate by Metal-Organic Chemical Vapor Deposition, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.46,** *No.2,* 491-495, 2007.
121. **M Tsukihara, K Sumiyoshi, T Okimoto, K Kataoka, S Kawamichi, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Effect of middletemperature intermediate layer on crystal quality of AlGaN grown on sapphire substrates by metal organic chemical vapor deposition, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.300,** *No.1,* 190-193, 2007.
122. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Monte Carlo Simulation of Hydrocarbon Redeposition on a Graphite Surface in Hydrogen Plasma, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.46,** *No.3A,* 1149-1156, 2007.
123. **Fawang Yan, Katsushi Nishino *and* Shiro Sakai :** Growth and Characteristics of GaN Film on Thin AlN/(0001) Sapphire Template Layer via Direct Reaction of Gallium and Ammonia, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 2 (Letters),* **Vol.45,** *No.27,* L697-L700, 2006.
124. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Hydrocarbon Redeposition in the plasma shadowed area and the gaps between diveroter tiles, *17th International Conference on Plasma Surface Interactions,* Hefei, China, May 2006.
125. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Tanabe T. *and* Takenaga H. :** Modeling of asymmetric redeposition distribution between inner and outer regions of the W-shaped divertor in JT-60U, *17th International Conference on Plasma Surface Interactions,* Hefei, China, May 2006.
126. **R.J. Choi, Shiro Sakai, Yoshiki Naoi, Katsushi Nishino, M. Koike *and* S.M. Lee :** Efficient non-polar a-plane light-emitting-diodes grown using AlInNbuffer and intermediate layer, *6th International Symposium on Blue Laser and Light Emitting Diodes,* Montpellier, May 2006.
127. **K. Sumiyoshi, M. Tsukihara, K. Kataoka, S. Kawamichi, T. Okimoto, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Al0.17Ga0.83N film with middle temperature intermediate layer grown on trenched sapphire substrate by MOCVD, *13th International Conference on Metal Organic Vapor Phase Epitaxy,* Miyazaki, May 2006.
128. **K. Ikeda, R.J. Choi, T. Fukumoto, K. Ono, Yoshiki Naoi, Katsushi Nishino *and* Shiro Sakai :** Visible light emitting diode using a-plane GaN on r-sapphire substrate with an InAlN buffer layer and a high temperature atomic layer epitaxy, *13th International Conference on Metal Organic Vapor Phase Epitaxy,* Miyazaki, May 2006.
129. **S. Kawamichi, Katsushi Nishino, K. Sumiyoshi, M. Tsukihara *and* Shiro Sakai :** Inversion domains in AlGaN films grown on patterned sapphire substrate, *13th International Conference on Metal Organic Vapor Phase Epitaxy,* Miyazaki, May 2006.
130. **M. Tsukihara, K. Sumiyoshi, T. Okimoto, K. Kataoka, S. Kawamichi, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Effect of middletemperature intermediate layer on crystal quality of AlGaN grown on sapphire substrates by metal organic chemical vapor deposition, *First International Symposium on Growth of III-Nitrides,* Linkoping, Jun. 2006.
131. **K. Matsuura, D. Kikuta, Jin-Ping Ao, H. Ogiya, M. Hiramoto, H. Kawai *and* Yasuo Ohno :** ICP Reactive Ion Etching with SiCl4 Gas for Recessed Gate AlGaN/GaN HFET, *The 2006 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2006),* Yokohama, Sep. 2006.
132. **Yoshiki Naoi, K. Ono, K. Ikeda, R.J. Choi, T. Fukumoto, Katsushi Nishino, Shiro Sakai, M. Koike *and* S.M. Lee :** Blue light emitting diode fabricated on a-plane GaN film over r-sapphire substrate and on a-plane bulk GaN substrate, *International Workshop on Nitride Semiconductors 2006,* Kyoto, Oct. 2006.
133. **Yoshiki Naoi, K. Ikeda, T. Hama, R.J. Choi, Katsushi Nishino, Shiro Sakai, M. Koike *and* S.M. Lee :** Investigation of InGaN films on a-plane GaN grown by metal organic chemical vapor deposition technique, *International Workshop on Nitride Semiconductors 2006,* Kyoto, Oct. 2006.
134. **Katsushi Nishino, A. Sakamoto *and* Shiro Sakai :** Growth of Thick a-plane GaN on r-plane Sapphire by Direct Synthesis Method, *International Workshop on Nitride Semiconductors 2006,* Kyoto, Oct. 2006.
135. **Jin-Ping Ao, Yoshikazu Matsuda, Yuya Yamaoka *and* Yasuo Ohno :** A Monolithic Cockcroft-Walton Voltage Multiplier Based on AlGaN/GaN HFET Structure, *International Workshop on Nitride Semiconductors 2006,* Kyoto, Oct. 2006.
136. **Masaya Okada, Kazuaki Matsuura, Jin-Ping Ao, Yasuo Ohno *and* Hiroji Kawai :** High-Sensitivity UV Phototransistor with GaN/AlGaN/GaN Gate Epi-Structure, *International Workshop on Nitride Semiconductors 2006,* Kyoto, Oct. 2006.
137. **Toshihiro Moriga, Hiroshi Suketa, Keisuke Takita, Daisuke Takada, Koji Shimomura, Kei-ichiro Murai *and* Kikuo Tominaga :** Transparent Conducting Amorphous ZnO-In2O3 Films Deposited on PC or PET Substrates, *American Vacuum Society 53rd International Symposium and Exhibition,* San Francisco, Nov. 2006.
138. **Kikuo Tominaga, Hiroshi Suketa, Keisuke Takita, Daisuke Takada, Koji Shimomura, Kei-ichiro Murai *and* Toshihiro Moriga :** Transparent Conductive Oxide Films of In2O3-ZnO with Additional Ga2O3 Impurities, *American Vacuum Society 53rd International Symposium and Exhibition,* San Francisco, Nov. 2006.
139. **Toshihiro Moriga, Katsuya Ishida, Akira Taki, Hirotaka Ohno, Yuji Sakakibara, Kei-ichiro Murai, Michio Mikawa *and* Kikuo Tominaga :** Characterization of ZnO-In2O3/ZnO Laminated Thin Films Prepared by Pulsed Laser Deposition, *American Vacuum Society 53rd International Symposium and Exhibition,* San Francisco, Nov. 2006.
140. **Retsuo Kawakami *and* Inaoka Takeshi :** Analysis of GaN Etching Damage by Capacitively Coupled RF Ar Plasma Exposure, *Proceedings of International Symposium of Dry Process,* 63-64, Nagoya, Nov. 2006.
141. **K. Ikeda, R. Matsuoka, T. Hama, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi, Shiro Sakai, M. Koike *and* S.M. Lee :** An a-GaN and an a-InGaN on r-Sapphire by Relatively High Temperature Metal organic Chemical Vapor Deposition, *The 3rd Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors,* Jeonju, Mar. 2007.
142. **谷口 太一, 井内 健介, 大宅 薫 :** 炭化水素分子の再付着分布への表面反射の影響, *第6回核融合エネルギー連合講演会,* 2006年6月.
143. **井内 健介, 大宅 薫 :** ダイバータタイル隙間の炭化水素再付着シミュレーション, *応用物理学会中国四国支部・日本物理学会中国支部四国支部・日本物理教育学会四国連絡会議2006年支部学術講演会,* 2006年7月.
144. **瀧田 啓介, 助田 祐志, 高田 大輔, 下村 幸司, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** 有機基板上に製膜したZnO-In2O3系透明導電性薄膜の特性, *応用物理学会中国四国支部 日本物理学会 中国支部・四国支部 日本物理教育学会 四国連絡会議 2006年度支部学術講演会,* 2006年7月.
145. **濱 敬重, 南部 紗織, 沖本 聖, 月原 政志, 片岡 研, 住吉 和英, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 高Al組成窒化物系UV-LED用Ni/Au系透明電極の解析, *応用物理学会中国四国支部，日本物理学会中国支部・四国支部，日本物理教育学会四国連絡会議2006年度支部学術講演会講演予稿集,* 137, 2006年7月.
146. **沖本 聖, 月原 政志, 住吉 和英, 片岡 研, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎, 酒井 士郎 :** 低温成長層の導入によるAlGaNの高品質化, *応用物理学会中国四国支部，日本物理学会中国支部・四国支部，日本物理教育学会四国連絡会議2006年度支部学術講演会講演予稿集,* 142, 2006年7月.
147. **住吉 和英, 月原 政志, 片岡 研, 沖本 聖, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 低温中間層による凸凹サファイア基板上Al0.17Ga0.83NのMOCVD, *応用物理学会中国四国支部，日本物理学会中国支部・四国支部，日本物理教育学会四国連絡会議2006年度支部学術講演会講演予稿集,* 143, 2006年7月.
148. **仁木 貴敏, 月原 政志, 沖本 聖, 住吉 和英, 片岡 研, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 中間温度成長AlGaN層と多重量子井戸(MQW)層によるMOCVD成長AlGaN中の転位低減, *応用物理学会中国四国支部，日本物理学会中国支部・四国支部，日本物理教育学会四国連絡会議2006年度支部学術講演会講演予稿集,* 144, 2006年7月.
149. **稲岡 武, 川上 烈生 :** 低温プラズマエッチングされたn-GaNのショットキー接合リーク電流特性, *日本物理学会中国四国支部 応用物理学会中国四国支部 平成18年度支部例会講演論文集,* 24, 2006年7月.
150. **川上 烈生, 稲岡 武 :** 容量結合型高周波プラズマによるGaNエッチングの解析, *日本物理学会中国四国支部 応用物理学会中国四国支部 平成18年度支部例会講演論文集,* 23, 2006年7月.
151. **川上 烈生, 稲岡 武 :** 容量性結合ArプラズマによるGaNエッチングダメージの解析, *第67回秋季応用物理学会学術講演会論文集, No.1,* 162, 2006年8月.
152. **助田 祐志, 瀧田 啓介, 高田 大輔, 下村 幸司, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** 有機基板上に作製したZnO-In2O3系アモルファス透明導電膜の特性, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
153. **西野 克志, 坂本 旭, 酒井 士郎 :** 直接合成法によるr面サファイア上へのバルクa-GaN成長, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
154. **西野 克志, 宮村 高史, 酒井 士郎 :** TMA添加直接合成法によるバルクAlGaNの結晶成長, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
155. **岡田 政也, 松浦 一暁, 敖 金平, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** GaNキャップ層ピエゾ電荷を用いたエンハンスメントモードAlGaN/GaN HFET, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
156. **石尾 隆幸, 岡田 政也, 敖 金平, 廣瀬 和之, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETしきい電圧の温度依存性の測定, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
157. **山岡 優哉, 岡田 政也, 敖 金平, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETしきい電圧のゲートストレスバイアス依存性, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
158. **池田 賢司, Rakjun Choi, 福本 哲也, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎, 小池 正好, S.M. Lee :** a面成長InGaN/GaN LEDにおけるInGaN活性層の解析, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
159. **谷口 太一, 井内 健介, 大宅 薫 :** 炭化水素分子の再付着分布への表面反射の影響(Ⅱ), *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* 2006年9月.
160. **片岡 研, 沖本 聖, 仁木 貴敏, 住吉 和英, 月原 政志, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** SiNを用いたAlInGaN系紫外LED高出力化の検討, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年9月.
161. **濱 敬重, 小野 耕大, 池田 賢司, Rakjun Choi, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎, S.M. Lee, 小池 正好 :** a面バルクGaNおよびr面サファイア上a面GaNに作製した青色発光ダイオード, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年9月.
162. **菅 良太, 佐藤 弘明, 敖 金平, 小中 信典, 入谷 忠光, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器を用いたチップ間ミリ波信号伝送, *2006年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2006年9月.
163. **川上 烈生, 稲岡 武 :** 非平衡RFプラズマの自己組織化構造とドライエッチングとの相関性, *平成18年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 16, 2006年9月.
164. **金子 悠祐, 小林 利成, 村井 寛幸, 宮本 佳典, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** RFスパッタリング法によるTiO2薄膜の作製とその評価, *化学工学会 徳島大会,* 2006年10月.
165. **井内 健介, 戎 真志, 大宅 薫 :** イオン反射とスパッタリングのMDシミュレーション, *プラズマ・核融合学会，第23回年会,* 2006年11月.
166. **岡田 政也, 国貞 雅也, 敖 金平, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** GaN/AlGaN/GaNフォトトランジスタを用いたUVセンサ回路, *2007年電子情報通信学会総合大会,* 2007年3月.
167. **奥山 祐加, 菅 良太, 佐藤 弘明, 小中 信典, 粟井 郁雄, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器無線接続における位置ずれの影響, *2007年電子情報通信学会総合大会,* 2007年3月.
168. **松岡 遼, 池田 賢司, 濱 敬重, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎, Rakjun Choi, S.M. Lee, 小池 正好 :** MOCVDにより直接高温成長した高品質a面GaN・InGaN結晶成長, *第54回応用物理学会学術講演会,* 2007年3月.
169. **金子 悠祐, 小林 利成, 村井 寛幸, 宮本 佳典, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** RFスパッタリング法により作製したTiO2:NbおよびTiO2:Ta薄膜の熱処理効果, *第54回応用物理学関連連合講演会,* 2007年3月.
170. **井上 研一, 富永 喜久雄, 続木 貴志, 三河 通男, 森賀 俊広 :** PLD法によるIn-Ga-Zn系酸化物透明導電性薄膜, *第54回応用物理学関係連合講演会講演予稿講集,* **Vol.2,** 704, 2007年3月.
171. **富永 喜久雄, 高田 大輔, 下村 孝司, 助田 裕志, 瀧田 啓介, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** In2O3-ZnO系透明導電膜へのGa2O3添加の影響, *第54回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,* **Vol.2,** 704, 2007年3月.
172. **瀧田 啓介, 助田 裕志, 高田 大輔, 下村 孝司, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** PCおよびPET基板に常温で成膜したZnO-In2O3系アモルファス透明導電膜の特性, *第54回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,* **Vol.Vol.2,** 704, 2007年3月.
173. **井内 健介, 大宅 薫 :** タイル隙間の 炭化水素堆積分布のシミュレーション, *第21回トライアム研究会&核融合フォーラムサブクラスター会合合同研究会,* 2006年8月.
174. **川上 烈生 :** プラズマの自己組織化と材料の損耗特性との関連性に関する研究, *平成18年度核融合科学研究所LHD数値解析システム利用共同研究報告書,* 日本, 2007年3月.
175. **川上 烈生 :** ITERのプラズマ対向壁材としてのタングステンの可能性に関する研究, *平成17-18年度科学研究費補助金, 若手研究(B),* 日本, 2007年3月.
176. **酒井 士郎, 他 :** 化合物半導体の最新技術 大全集, 株式会社 技術情報協会, 東京, 2007年4月.
177. **Kaoru Ohya *and* Tohru Ishitani :** Focused Ion Beam Systems; Basics and Applications, Cambridge University Press, Cambridge, Sep. 2007.
178. **Kazuaki Matsuura, Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao, Hiromichi Ogiya, Michihiro hiramoto, Hiroji Kawai *and* Yasuo Ohno :** Inductively Coupled Plasma Reactive Ion Etching with SiCl4 Gas for Recessed Gate AlGaN/GaN Heterostructure Field Effect Transistor, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.46,** *No.4B,* 2320-2324, 2007.
179. **M Yamamoto, Y Hamazaki, M Tsukihara, Yoshiki Naoi, Katsushi Nishino *and* Shiro Sakai :** Growth of AlN and GaN by metalorganic chemical vapor deposition on BP synthesized by flux method, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 2 (Letters),* **Vol.46,** *No.14,* L323-L325, 2007.
180. **Masaya Okada, Kazuaki Matsuura, Jin-Ping Ao, Yasuo Ohno *and* Hiroji Kawai :** High-sensitivity UV phototransistor with GaN/AlGaN/GaN gate epi-structure, *Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science,* **Vol.204,** *No.6,* 2117-2120, 2007.
181. **Jin-Ping Ao, Yoshikazu Matsuda, Yuya Yamaoka *and* Yasuo Ohno :** A monolithic Cockcroft-Walton voltage multiplier based on AlGaN/GaN HFET structure, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.4,** *No.7,* 2654-2657, 2007.
182. **Yoshiki Naoi, K. Ikeda, T. Hama, K. Ono, R. Choi, T. Fukumoto, Katsushi Nishino, Shiro Sakai, S. M. Lee *and* M. Koike :** Blue light emitting diode fabricated on a-plane GaN film over r-sapphire substrate and on a-plane bulk GaN substrate, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.4,** *No.7,* 2810-2813, 2007.
183. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Simulation of hydrocarbon redeposition in the gaps between divertor tiles, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.363-365,** 915-919, 2007.
184. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Tetsuo Tanabe *and* Hidenobu Takenaga :** Modeling of asymmetric redeposition distribution between inner and outer regions of the W-shaped divertor in JT-60U, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.363-365,** 78-85, 2007.
185. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya *and* Tohru Ishitani :** Simulation study on image contrast and spatial resolution in helium ion microscope, *Journal of Electron Microscopy,* **Vol.56,** *No.5,* 163-169, 2007.
186. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Nisawa Koji *and* Itoh Akio :** Emission statistics of X-ray induced photoelectrons and its comparison with electron- and ion-induced electron emissions, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms,* **Vol.266,** 541-548, 2007.
187. **Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Minamoto Shingo *and* Kikuhara Yasuyuki :** Analysis of GaN Etching Damage by Capacitively Coupled RF Ar Plasma Exposure, *Thin Solid Films,* **Vol.516,** *No.11,* 3478-3481, 2008.
188. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Simulation of Hydrocarbon Redeposition on Plasma Shadowed Areas, *Contributions to Plasma Physics,* **Vol.48,** *No.1-3,* 275-279, 2008.
189. **Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Annealing with Ni for ohmic contact formation on ICP-etched p-GaN, *Electronics Letters,* **Vol.44,** *No.2,* 155-157, 2008.
190. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Simulation of Hydrocarbon Redeposition on Plasma Shadowed Areas, *11th International Workshop on Plasma Edge Theory in Fusion Devices,* Gifu, May 2007.
191. **Shimomura Kouji, Kikuo Tominaga, Takada Daisuke, Suketa Hiroshi, Takita Keiji, Kei-ichiro Murai *and* Toshihiro Moriga :** In2O3-ZnO transparent conductive oxide film deposition on polycarbonate substrate, *Proc. of the nineth International Symposium on Sputtering & Plasma Processes,* 445-448, Kanazawa, Jun. 2007.
192. **Kikuo Tominaga, Takada Daisuke, Shimomura Kouji, Suketa Hiroshi, Takita Keisuke, Kei-ichiro Murai *and* Toshihiro Moriga :** Influence of additional ga2O3 on transparent conductive oxide films of In2O3-ZnO, *Proc. of the nineth International Symposium on Sputtering & Plasma Processes,* 449-452, Kanazawa, Jun. 2007.
193. **Retsuo Kawakami *and* Inaoka Takeshi :** Effect of Argon Plasma Etching Damage on Electrical Characteristics, *Proceedings of 9th International Symposium of Sputtering & Plasma Processes,* 391-394, Kanazawa, Jun. 2007.
194. **Inoue Kenichi, Kikuo Tominaga, Tsuduki Takashi, Mikawa Michio *and* Toshihiro Moriga :** Film deposition of transparent conductive In-Ga-Zn oxides by PLD method, *Proc. of the nineth International Symposium on Sputtering & Plasma Processes,* 441-444, Kanazawa, Jun. 2007.
195. **Kikuo Tominaga, Miyamoto Yoshinori, Ohkura Shinya, Kazuya Kusaka *and* Takao Hanabusa :** Comparison of film depositions of anatase TiO2 by planar magnetron sputtering with opposed Ti targets and conventional Ti targets, *The 20th Symposium on Plasma Science for Materials,* 108, Nagoya, Jun. 2007.
196. **Mikawa Michio, Kikuo Tominaga, Inoue Kenichi, Tsuduki Takashi *and* Toshihiro Moriga :** Influence of additional impurities on the properties of In-Zn-O transparent conductive oxide films, *The 20th Symposium on Plasma Science for Materials,* 110, Nagoya, Jun. 2007.
197. **Jin-Ping Ao, Yuya Yamaoka, Masaya Okada, Cheng-Yu Hu *and* Yasuo Ohno :** Investigation on Current Collapse of AlGaN/GaN HFET by Gate Bias Stress, *2007 Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Chiba, Aug. 2007.
198. **Cheng-Yu Hu, K. Matsuura, Masaya Okada, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Ohmic Contact for Dry-Etched p-GaN Realized by High Temperature Annealing, *2007 Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Chiba, Aug. 2007.
199. **Ryosuke Sumitomo, Kaoru Ohya, Hitoshi Tanaka *and* Fuji Ren :** Designing of Campus Information Navigator based on Human-Machine Dialog, *IEEE NLP-KE2007 Poster Session,* 111-116, Beijing, Aug. 2007.
200. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Hideaki Kuwada, Teruyuki Hayashi *and* Misako Saitoh :** Dynamic simulation of secondary electron emission and charging up of an insulating material, *6th Asian-Europian International Conference on Plasma Surface Engineering,* Nagasaki, Sep. 2007.
201. **Kensuke Inai, Yasuyuki Kikuhara *and* Kaoru Ohya :** Comparison of carbon deposition on plasma-exposed tungsten between molecular dynamics and dynamic Monte Carlo simulation, *6th Asian-Europian International Conference on Plasma Surface Engineering,* Nagasaki, Sep. 2007.
202. **T Okimoto, M Tsukihara, K Kataoka, A Kato, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** GaN- and AlGaN-based UV-LEDs on Sapphire by Metalorganic Chemical Vapor Deposition, *The 34th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS 2007),* Kyoto, Oct. 2007.
203. **Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao, M. Okada, M. Sugimoto, T. Uesugi, T. Kachi *and* Yasuo Ohno :** Low Resistance Ohmic Contact Formation to Dry-Etched p-GaN, *The 34th International Symposium on Compound Semiconductors,* Kyoto, Oct. 2007.
204. **M Tohno, T Okimoto, Yoshiki Naoi, Katsushi Nishino, Shiro Sakai, T Kusuura, A Mitra, S Nouda, M Kimura, S Kawano *and* Y Muramoto :** GaN-LED's on nano-etched sapphire substrate by metal organic chemical vapor deposition, *The first International conference on White Light-Emitting Diodes(LEDs) and Solid State Lighting (SSL),* Tokyo, Nov. 2007.
205. **Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi *and* Mukai Takashi :** Synergy effect of Particle and Ultraviolet Radiations from Capacitively Coupled RF Argon Plasmas on n-GaN Etching Damage, *Proceedings of International Symposium of Dry Process,* 181-182, Tokyo, Nov. 2007.
206. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** EDDY code and PIC sheath code, *Workshop on Theory and Simulation of Boundary Plasmas,* Gifu, Mar. 2008.
207. **續木 貴志, 富永 喜久雄, 井上 研一, 三河 通男, 森賀 俊広 :** PLD法によるIn-Ga-Zn-O酸化物透明導電性薄膜, *平成19年度電気関係学会四国支部連合大会講演予稿集,* 130, 2007年9月.
208. **井上 研一, 富永 喜久雄, 續木 貴志, 三河 通男, 森賀 俊広 :** 不純物添加によるIn-Zn-O系酸化物透明導電膜の特性への影響, *平成19年度電気関係学会四国支部連合大会講演予稿集,* 123, 2007年9月.
209. **坂本 晃彦, 富永 喜久雄, 下村 幸司, 瀧田 啓介, 森賀 俊広, 中林 一朗 :** 1In2O3-ZnO系酸化物透明導電膜へのGa2O3添加による影響, *平成19年度電気関係学会四国支部連合大会講演予稿集,* 131, 2007年9月.
210. **岡田 健司, 富永 喜久雄, 大倉 信也 :** 不平衡マグネトロンスパッタ法と対向型マグネトロンスパッタ法によるTiO2膜の作製, *平成19年度電気関係学会四国支部連合大会講演予稿集,* 129, 2007年9月.
211. **下村 幸司, 富永 喜久雄, 高田 大輔, 助田 祐志, 瀧田 啓介, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** PC基板上へのIn2O3-ZnO系酸化物透明導電膜の作製, *平成19年度電気関係学会四国支部連合大会講演予稿集,* 127, 2007年9月.
212. **大倉 信也, 富永 喜久雄, 岡田 健司, 納田 隆弘, 白石 健太郎 :** 対向型マグネトロンスパッタリング法によるTiO2薄膜作製と光触媒の評価, *平成19年度電気関係学会四国支部連合大会講演予稿集,* 124, 2007年9月.
213. **川上 烈生, 稲岡 武 :** 容量結合型アルゴンプラズマエッチングダメージによるn-GaNの電子的特性, *第68回秋季応用物理学会学術講演会論文集, No.1,* 178, 2007年9月.
214. **大野 泰夫, 山岡 優哉, 岡田 政也, 胡 成余, 敖 金平 :** ゲートストレスバイアスによるAlGaN/GaN MIS HFETの電流コラプス評価, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
215. **野久 保宏幸, 岡田 政也, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** GaN MISダイオードによる絶縁膜界面評価, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
216. **澤田 剛一, 新海 聡子, 敖 金平, 岡田 政也, 胡 成余, 廣瀬 和之, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** n‐GaNへの高温処理ZrN電極ショットキー特性, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
217. **胡 成余, 岡田 政也, 敖 金平, 大野 泰夫 :** Ni処理を用いたドライエッチp‐GaNへの低抵抗オーミック形成, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
218. **敖 金平, 澤田 剛一, 新海 聡子, 岡田 政也, 胡 成余, 廣瀬 和之, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** TiNゲートAlGaN/GaN HFETの特性評価, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
219. **富永 喜久雄, 宮本 佳典, 大倉 信也, 岡田 健司 :** 対向型マグネトロン(PM)スパッタ法と不平衡PMスパッタ法によるTiO2膜の作製, *第68回応用物理学会学術講演会講演予稿集,* **Vol.2,** 638, 2007年9月.
220. **富永 喜久雄, 三河 通男, 井上 研一, 続木 貴志 :** In-Zn-Oアモルファス透明導電膜への不純物添加の影響, *第68回応用物理学会学術講演会講演予稿集,* **Vol.2,** 666, 2007年9月.
221. **遠野 充明, 沖本 聖, 加藤 篤, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎, 楠浦 崇央, ミトラ アヌパム :** ナノ・エッチングしたサファイア上へのGaNのMOCVD成長, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
222. **奥山 祐加, 柏原 俊彦, 敖 金平, 粟井 郁雄, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器を用いたチップ間マイクロ波信号伝送, *2007年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2007年9月.
223. **遠野 充明, 沖本 聖, 直井 美貴, 西野 克志, 楠浦 崇央, ミトラ アヌパム, 納田 卓, 木村 真大, 川野 俊輔, 村本 宣彦 :** ナノ・エッチングしたサファイア基板上へのGaN-LEDのMOCVD成長, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* **Vol.11-5,** 2007年9月.
224. **加藤 篤, 月原 政志, 片岡 研, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** UV-LED用高Al組成AlGaN結晶の高品質化に関する研究, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* **Vol.11-11,** 2007年9月.
225. **松岡 遼, 池田 賢司, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** オフ角r面サファイア基板上にMOCVD法によるa面GaNのX線回折による評価, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* **Vol.11-14,** 2007年9月.
226. **仁木 貴敏, 片岡 研, 月原 政志, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** MOCVD成長AlGaNのMgドーピングによる結晶性への影響, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* **Vol.11-22,** 2007年9月.
227. **南部 紗織, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** AlGaN系紫外LEDのエレクトロルミネッセンスの温度特性, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* **Vol.11-11,** 2007年9月.
228. **沖本 聖, 遠野 充明, 南部 紗織, 北村 政治, 月原 政志, 片岡 研, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** AlGaN系紫外発光ダイオードの光出力に及ぼす電極形状の影響に関する研究, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* **Vol.11-29,** 2007年9月.
229. **川上 烈生, 稲岡 武 :** 容量結合型高周波プラズマナノプロセスリアクタの開発と放電及び分光特性, *平成19年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 18, 2007年9月.
230. **菊原 康之, 井内 健介, 大宅 薫 :** タングステン表面への炭素再堆積のMDシミュレーション, *プラズマ・核融合学会24回年会,* 2007年11月.
231. **井内 健介, 大宅 薫 :** プラズマ照射のないタイル表面への炭化水素再付着のシミュレーション, *プラズマ・核融合学会，第24回年会,* 2007年11月.
232. **大宅 薫, 井内 健介, 二澤 宏司, 伊藤 秋男 :** 1-100keV単色X線照射による金属の二次電子放出シミュレーション, *プラズマ・核融合学会，第24回年会,* 2007年11月.
233. **瀧田 啓介, 渡邊 隆之, 下村 幸司, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** PC基板上に製膜した酸化亜鉛-酸化インジウム系アモルファス薄膜へのAlドーピングによる特性向上, *第46回セラミックス基礎科学討論会,* 2008年1月.
234. **大宅 薫 :** プラズマ対向壁の損耗・再堆積のシミュレーション, *核融合エネルギーフォーラム 周辺&ペデスタル物理クラスタ会合,* 2008年2月.
235. **伊藤 秀起, 高橋 健介, 原内 貴司, 岡田 政也, 胡 成余, 敖 金平, 河合 弘治, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 大野 泰夫, 井川 裕介 :** マイクロ波整流用GaNショットキーダイオードの特性評価, *2008年電子情報通信学会総合大会,* 2008年3月.
236. **岡田 健司, 富永 喜久雄, 大倉 信也 :** RF-DC結合形スパッタ法と対向型スパッタ法によるTiO2薄膜の作製, *第55回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,* **Vol.2,** 610, 2008年3月.
237. **坂本 晃彦, 富永 喜久雄, 下村 幸司, 植野 貴大, 瀧田 啓介, 渡邊 隆之, 森賀 俊広, 中林 一朗 :** In2O3-ZnO系酸化物透明導電膜へのGa2O3添加の影響, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
238. **續木 貴志, 富永 喜久雄, 井上 研一, 三河 通男, 森賀 俊広, 中林 一朗 :** PLD法によるIn-Ga-Zn系酸化物透明導電性薄膜, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
239. **坂本 晃彦, 富永 喜久雄, 下村 幸司, 植野 貴大, 瀧田 啓介, 渡辺 隆之, 森賀 俊広, 中林 一郎 :** In2O3-ZnO系酸化物透明導電膜へのGa2O3添加の影響, *第55回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,* **Vol.2,** 640, 2008年3月.
240. **松岡 遼, 沖本 聖, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 金属蒸着膜を使ったAlGaN on GaN/Sapphireの選択MOCVD成長, *2008年(平成20年)春季第55回応用物理学会連合講演会,* 29p-B-18, 2008年3月.
241. **胡 成余, 敖 金平, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** p-基板層付きAlGaN/GaN HFETのVt-Vsub特性, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
242. **高橋 健介, 伊藤 秀起, 原内 貴司, 岡田 政也, 胡 成余, 敖 金平, 河合 弘治, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 大野 泰夫, 井川 裕介 :** GaNを用いたマイクロ波整流用ショットキーバリアダイオード, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
243. **R Matsuoka, K Ikeda, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Chracterization of a-plane MOCVD-grown GaN on off-angle r-plane sapphire substrates, *26th Electronic Materials Symposium (EMS-26),* **Vol.E12,** Jul. 2007.
244. **K Kataoka, M Tsukihara, T Niki, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** The segragation and saturation phenomena of Mg concentration in AlGaN, *26th Electronic Materials Symposium (EMS-26),* **Vol.H7,** Jul. 2007.
245. **北村 政治, 沖本 聖, 遠野 充明, 南部 紗織, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 340nm帯ナイトライド系 UV-LEDの自己発熱と電流集中効果による発光特性への影響, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* **Vol.P1,** 2007年12月.
246. **松岡 遼, 池田 賢司, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** オフ角r面サファイア上MOCVD成長a面GaNのX線回折評価, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* **Vol.P2,** 2007年12月.
247. **遠野 充明, 沖本 聖, 直井 美貴, 西野 克志, 酒井 士郎, 楠浦 崇央, ミトラ アムパム, 納田 卓, 木村 真大, 川野 俊輔, 村本 宣彦 :** ナノ微細加工サファイア基板上へのGaN系発光ダイオードの作製, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* **Vol.P3,** 2007年12月.
248. **川上 烈生 :** 高周波プラズマの自己組織化と材料損耗特性との相関性, *平成19年度核融合科学研究所LHD数値解析システム利用共同研究報告書,* 日本, 2008年3月.
249. **川上 烈生 :** 窒化物系半導体デバイスのためのプラズマ誘因ダメージレスナノプロセス装置の研究開発, *平成19年度教育研究等支援事業(学長裁量経費)報告書,* 日本, 2008年3月.
250. **Retsuo Kawakami *and* Inaoka Takeshi :** Effect of Argon Plasma Etching Damage on Electrical Characteristics of Gallium Nitride, *Vacuum,* **Vol.83,** *No.3,* 490-492, 2008.
251. **Masaya Okada, Hideki Ito, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Mechanism of AlGaN/GaN Heterostructure Field-Effect Transistor Threshold Voltage Shift by Illumination, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.47,** *No.4,* 2103-2107, 2008.
252. **T Okimoto, M Tsukihara, K Kataoka, A Kato, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** GaN- and AlGaN-based UV-LEDs on Sapphire by Metalorganic Chemical Vapor Deposition, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.5,** *No.9,* 3066-3068, 2008.
253. **Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao, Masaya Okada *and* Yasuo Ohno :** A Study on Ohmic Contact to Dry-Etched p-GaN, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E91-C,** *No.7,* 1020-1024, 2008.
254. **Jin-Ping Ao, Yuya Yamaoka, Masaya Okada, Cheng-Yu Hu *and* Yasuo Ohno :** Investigation on Current Collapse of AlGaN/GaN HFET by Gate Bias Stress, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E91-C,** *No.7,* 1004-1008, 2008.
255. **Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Kuwahara Akinobu, Kikuo Tominaga *and* Mukai Takashi :** Synergy Effect of Particle Radiation and Ultraviolet Radiation from Capacitively Coupled Radio Frequency Argon Plasmas on n-GaN Etching Damage, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.47,** *No.8,* 6863-6866, 2008.
256. **Kensuke Inai, Yasuyuki Kikuhara *and* Kaoru Ohya :** Comparison of carbon deposition on tungsten between molecular dynamics and dynamic Monte Carlo simulation, *Surface & Coatings Technology,* **Vol.202,** *No.22-23,* 5374-5378, 2008.
257. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Hideaki Kuwada, Teruyuki Hayashi *and* Misako Saito :** Dynamic simulation of secondary electron emission and charging up of an insulating material, *Surface & Coatings Technology,* **Vol.202,** *No.22-23,* 5310-5313, 2008.
258. **Toshihiro Moriga, Koji Shimomura, Daisuke Takada, Hiroshi Suketa, Keisuke Takita, Kei-ichiro Murai *and* Kikuo Tominaga :** In2O3-ZnO transparent conductive oxide film deposition on polycarbonate substrates, *Vacuum,* **Vol.83,** *No.3,* 557-560, 2008.
259. **Kikuo Tominaga, Daisuke Takada, Koji Shimomura, Hiroshi Suketa, Keisuke Takita, Kei-ichiro Murai *and* Toshihiro Moriga :** Influence of Ga2O3 addition on transparent conductive oxide films of In2O3-ZnO, *Vacuum,* **Vol.83,** *No.3,* 561-563, 2008.
260. **Kenichi Inoue, Kikuo Tominaga, Takashi Tsuduki, Michio Mikawa *and* Toshihiro Moriga :** The properties of transparent conductive In-Ga-Zn oxide films produced by pulsed laser deposition, *Vacuum,* **Vol.83,** *No.3,* 552-556, 2008.
261. **Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** Future Applications of GaN Electron Devices, *Semiconductor Technology,* **Vol.33,** *No.12,* 72-74, 2008.
262. **Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Refractory Metal Nitride Schottky Contact on GaN, *Semiconductor Technology,* **Vol.33,** *No.12,* 75-79, 2008.
263. **Kaoru Ohya, Takuya Yamanaka, Kensuke Inai *and* Tohru Ishitani :** Comparison of secondary electron emission in helium ion microscope with gallium ion and electron microscopes, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms,* **Vol.267,** *No.4,* 584-589, 2009.
264. **大宅 薫, 相良 明男 :** 今，核融合炉の壁が熱い! 第3回 III. 壁の表面で何が起きているか, *日本原子力学会誌,* **Vol.50,** *No.8,* 511-515, 2008年8月.
265. **酒井 士郎 :** 短波長LEDチップを用いた白色照明, *光学,* **Vol.38,** *No.3,* 127-131, 2009年3月.
266. **Yasuyuki Kikuhara, Kensuke Inai, Atsushi Ito, Hiroaki Nakamura *and* Kaoru Ohya :** Hydrocarbon Reflection and Redeposition on Plasma-Facing Surfaces, *2nd Japan-China Workshop on Blanket and Tritium Technology,* 38-41, Sendai, Japan, May 2008.
267. **Kaoru Ohya, Yasuyuki Kikuhara, Kensuke Inai, Andreas Kirschner, D. Borodin, Atsushi Ito, Hiroaki Nakamura *and* Tetsuo Tanabe :** Simulation of hydrocarbon reflection from carbon and tungsten surfaces and its impact on codeposition patterns on plasma facing components, *18th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* Toledo, Spain, May 2008.
268. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya, Yukihiro Tomita, Andreas Kirschner, A. Litnovsky *and* Tetsuo Tanabe :** Simulation of redeposition of carbon/hydrocarbon on a material surface with castellated structures, *18th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* Toledo, Spain, May 2008.
269. **Daiji Kato, Takahiro Kenmotsu, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Excited state distribution of reflected hydrogen atoms at metal surfaces - Development of theoretical models -, *18th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* Toledo, Spain, May 2008.
270. **Kazuo Hoshio, Mitsunori Toma, M. Furuibayashi, Akiyoshi Hatayama, Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Numerical Analysis of Incident Angle of Heavy Metal Impurity to Plasma Facing Components by IMPGYRO, *18th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* Toledo, Spain, May 2008.
271. **Mitsunori Toma, Kazuo Hoshino, Kensuke Inai, M. Ishida, Akiyoshi Hatayama *and* Kaoru Ohya :** Coupled IMPGYRO-EDDY simulation of tungsten impurity transport in tokamak geometry, *18th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* Toledo, Spain, May 2008.
272. **Kikuo Tominaga, Tsuduki Takashi, Inoue Ken-ichi, Mikawa Michio *and* Toshihiro Moriga :** Film properties of amorphous transparent conductive In-Ga-Zn oxides deposited on fuzed quartz by the PLD method, *14th International Conference on Solid Films and Surfaces,* 329, Dublin, Jul. 2008.
273. **Okada Kenji, Kikuo Tominaga, Retsuo Kawakami, Ohkura Shinya, Kazuya Kusaka *and* Takao Hanabusa :** Deposition of photocatalytic tiO2 films by planar magnetron sputtering system with opposed Ti targets, *14th International Conference on Solid Films and Surfaces,* 331-332, Dublin, Jul. 2008.
274. **Ryo Matsuoka, Takashi Okimoto, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** AlGaN epitaxial lateral overgrowth on Ti-evaporated GaN/sapphire substrate, *Second International Symposium on Growth of III-Nitrides,* MO-44, Izu, Jul. 2008.
275. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya, Gakushi Kawamura *and* Yukihiro Tomita :** An EDDY-PIC Simulation of Codeposition of Hydrocarbon Isotopes on Castellated Structure of Plasma Facing Tiles, *14th International Congress on Plasma Physics,* Fukuoka, Sep. 2008.
276. **Yasuyuki Kikuhara, Kensuke Inai, Kaoru Ohya, Atsushi Ito *and* Hiroaki Nakamura :** Molecular dynamics simulation of hydrocarbon reflection of carbon and tungsten in realistic surface condition, *14th International Congress on Plasma Physics,* Fukuoka, Sep. 2008.
277. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Yasuyuki Kikuhara, T. Nakano, Jun Kawada, Hayato Kawazome, Yoshio Ueda *and* Tetsuo Tanabe :** Transport of heavy hydrocarbon and its redeposition on plasma facing walls, *14th International Congress on Plasma Physics,* Fukuoka, Sep. 2008.
278. **Mitsunori Toma, Kazuo Hoshino, Kensuke Inai, M. Ishida, Akiyoshi Hatayama *and* Kaoru Ohya :** Analysis of the high-Z impurity transport in a tokamak by the IMPGYRO code, *14th International Congress on Plasma Physics,* Fukuoka, Sep. 2008.
279. **Kaoru Ohya :** Modeling of hydrocarbon transport and redeposition in gaps, *11th ITPA meeting on SOL/divertor physics,* Nagasaki, Sep. 2008.
280. **Kaoru Ohya, Takuya Yamanaka, Kensuke Inai *and* Tohru Ishitani :** Comparison of secondary electron emission in helium ion microscope with gallium ion and electron microscopes, *17th International Workshop on Inelastic Ion-Surface Collisions,* Porquerolles, France, Sep. 2008.
281. **K. Takahashi, Jin-Ping Ao, Y. Ikawa, C. -Y. Hu, H. Kawai, N. Shinohara, N. Niwa *and* Yasuo Ohno :** GaN Schottky Diodes for Microwave Power Rectification, *The 2008 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2008),* Tsukuba, Sep. 2008.
282. **Cheng-Yu Hu, Katsutoshi Nakatani, Daigo Kikuta, Masahiro Sugimoto, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** VT-VSUB Characterization of AlGaN/GaN HFET with Regrown Epi-layer on p-GaN, *The 2008 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2008),* Tsukuba, Sep. 2008.
283. **Yuka Okuyama, Jin-Ping Ao, Ikuo Awai *and* Yasuo Ohno :** Wireless Inter-Chip Signal Transmission by Electromagnetic Coupling of Open-Ring Resonators, *The 2008 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2008),* Tsukuba, Sep. 2008.
284. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Yasuyuki Kikuhara, Atsushi Ito, Hiroaki Nakamura, Yukihiro Tomita *and* Tetsuo Tanabe :** Modeling of Hydrocarbon Redeposition in the Gaps of Castellated Structures, *Proceedings of 22nd IAEA Fusion Energy Conference, TH/P4-8,* Geneva, Oct. 2008.
285. **Katsuhiro Shimizu, Tomonori Takizuka, Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Tomohide Nakano, A. Takayama *and* Hisato Kawashima :** Kinetic Modeling of Impurity Transport in Detached Plasma for Integrated Divertor Simulation with SONIC (SOLDOR/NEUT2D/IMPMC/EDDY), *Proceedings of 22nd IAEA Fusion Energy Conference, TH/3-3,* Geneva, Oct. 2008.
286. **Heng-Yu Xu, Jin-Ping Ao, Hui Yu, Cheng-Yu Hu *and* Yasuo Ohno :** Device Isolation for AlGaN/GaN HFET Utilizing Heavy Metal Diffusion, *IEEE Nanotechnology Materials and Device Conference 2008 (NMDC2008),* Kyoto, Oct. 2008.
287. **Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Kikuo Tominaga, Mukai Takashi, Hiraoka Kensaku, Kudo Yuki *and* Koide Kuniyuki :** Model Analysis of Preferential Etching of III-V Nitrides by Capacitively Coupled Radio Frequency Argon Plasmas, *4th Vacuum and Surface Sciences Conference of Asia and Australia,* 187, Matsue, Oct. 2008.
288. **Okada Kenji, Kikuo Tominaga, Ohokura Sinya, Nouda Takahiro *and* Retsuo Kawakami :** Deposition of TiO2 films by a RF-DC Coupled Magnetron Sputtering, *4th Vacuum and Surface Sciences Conference of Asia and Australia,* 217, Matsue, Oct. 2008.
289. **Ikuo Awai, Kunihito Hori, Yuka Okuyama *and* Yasuo Ohno :** Non-contact Signal Transmission Based on Open Ring Resonator BPF, *Proceedings of the 38th European Microwave Conference,* Amsterdam, Oct. 2008.
290. **Daiji Kato, Takahiro Kenmotsu, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Polarization of excited states of atomic hydrogen reflected at Mo surface, *6th International Conference on Atomic and Molecular Data and Their Applications,* Beijing, Oct. 2008.
291. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya, Hideaki Kuwada, Ryosuke Kawasaki, Misako Saito, Kaoru Fujiwara, Teruyuki Hayashi, Jack Jau *and* Kenichi Kanai :** Electron beam charging of a SiO2 layer on Si: a comparison between Monte Carlo-simulated and experimental results, *Proceedings of SPIE,* **Vol.7140,** 71400X, Taipei, Nov. 2008.
292. **Kaoru Ohya, Takuya Yamanaka, Kensuke Inai *and* Tohru Ishitani :** Modeling of secondary electron image contrasts in helium ion microscope, *SPIE Lithography Asia Taiwan 2008,* Taipei, Nov. 2008.
293. **Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Kikuo Tominaga *and* Mukai Takashi :** Effects of Capacitively Coupled Radio Frequency Krypton and Argon Plasmas on Gallium Nitride Etching Damage, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2008,* 187-188, Tokyo, Nov. 2008.
294. **Naoki Shinohara, Yushi Miyata, Tomohiko Mitani, Naoki Niwa, Kenji Takagi, Kenichi Hamamoto, Satoshi Ujigawa, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** New Application of Microwave Power Transmission for Wireless Power Distribution System in Buildings, *Asia Pacific Microwave Conference 2008,* Hong Kong, Dec. 2008.
295. **Takuya Yamanaka, Kensuke Inai, Kaoru Ohya *and* Tohru Ishitani :** Simulation of secondary-electron emission in helium ion microscope for overcut and undercut line-edge patterns, *Proceedings of SPIE,* **Vol.7272,** 72722L, SanJose, CA, USA, Feb. 2009.
296. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya, Ryosuke Kawasaki, Hideaki Kuwada, Misako Saito, Teruyuki Hayashi, J. Jau *and* K. Kanai :** Simulation of SEM images and charging of an insulator/metal bilayer in trench/hole patterns, *SPIE Advanced Lithography 2009,* San Nose, California, USA, Feb. 2009.
297. **Daiji Kato, H. Iwakiri, K. Morishita, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Hydrogen trapping and erosion of W crystal, *IAEA 2nd CRM "Data for surface composition dynamics relevant to erosion processes",* Vienna, Austria, Mar. 2009.
298. **山中 卓也, 井内 健介, 大宅 薫, 石谷 亨 :** ヘリウムイオン顕微鏡における二次電子信号の評価シミュレーション, *日本顕微鏡学会，第64回学術講演会,* 2008年5月.
299. **藤間 光徳, 星野 一生, 井内 健介, 石田 真彦, 畑山 明聖, 大宅 薫 :** トカマク不純物コードIMPGYROと損耗・再堆積コードEDDYとの結合, *第7回核融合エネルギー連合講演会,* 2008年6月.
300. **大宅 薫, 井内 健介, 菊原 康之, 冨田 幸博, 中村 浩章, 伊藤 篤史, 田辺 哲朗 :** プラズマ対向壁における炭化水素の反射と再堆積, *第7回核融合エネルギー連合講演会,* 2008年6月.
301. **敖 金平, 許 恒宇, 于 僡, 胡 成余, 大野 泰夫 :** Ni拡散によるAlGaN/GaN HFET素子分離, *第69回応用物理学会学術講演会,* 2008年9月.
302. **胡 成余, 中谷 克俊, 敖 金平, 菊田 大悟, 杉本 雅裕, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET VT-VSUB特性を用いたp-GaN上バッファ層の評価, *第69回応用物理学会学術講演会,* 2008年9月.
303. **井川 裕介, 湯浅 頼英, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETのゲートエッジ表面負帯電におけるDC特性の解析, *第69回応用物理学会学術講演会,* 2008年9月.
304. **星野 一生, 藤間 光徳, 井内 健介, 石田 真彦, 畑山 明聖, 大宅 薫 :** IMPGYROコードによるトカマク周辺プラズマにおける重金属不純物輸送のシミュレーション, *第2回シミュレーション科学シンポジウム,* 2008年9月.
305. **井内 健介, 菊原 康之, 大宅 薫, 伊藤 篤史, 中村 浩章, 河村 学思, 冨田 幸博 :** プラズマ対向壁における損耗・堆積のシミュレーション, *第2回シミュレーション科学シンポジウム,* 2008年9月.
306. **大宅 薫, 井内 健介, 菊原 康之, 冨田 幸博, 中村 浩章, 伊藤 篤史, 田辺 哲朗 :** プラズマ対向壁における炭化水素再付着のシミュレーション, *日本原子力学会，2008年秋の大会,* 2008年9月.
307. **松岡 遼, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** ストライプ状金属蒸着膜を使ったAlGaN on GaN/Sapphireの選択MOCVD成長, *2008年(平成20年)秋季第69回応用物理学会学術講演会,* 2a-CA-8, 2008年9月.
308. **川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** GaNエッチングダメージへのアルゴンプラズマ粒子と紫外放射光のシナジー効果, *第69回秋季応用物理学会学術講演会論文集, No.1,* 175, 2008年9月.
309. **續木 隆志, 富永 喜久雄, 丸山 貴之, 三河 通男, 森賀 俊広 :** PLD法により石英基板上へ作製したIn-Ga-Zn系酸化物透明導電性薄膜の特性, *第69回応用物理学会学術講演会講演予稿集,* 526, 2008年9月.
310. **川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 平岡 謙作, 工藤 裕貴, 小出 訓之, 向井 孝志 :** n-GaNのアルゴンプラズマエッチングダメージ, *平成20年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 13, 2008年9月.
311. **森 一郎, 森本 敏文, 川上 烈生 :** 揺らぎを介する二個のビーム電子とイオンの相互作用と集団`CLUMP'の形成, *平成20年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 12, 2008年9月.
312. **加藤 篤, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** SiO2 を斜め蒸着した凹凸GaN テンプレート上へのGaN成長, *平成20年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-1, 2008年9月.
313. **結城 勇介, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 直接合成法を用いたa 面GaN 結晶成長のためのNH3 流量の検討, *平成20年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-2, 2008年9月.
314. **遠野 充明, 直井 美貴, 酒井 士郎, 和地 順蔵 :** ナノインプリント技術によるサファイア基板上へのナノ構造の形成, *平成20年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-3, 2008年9月.
315. **南部 紗織, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 表面プラズモンポラリトンによる半導体LED の出力改善に関する検討, *平成20年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-4, 2008年9月.
316. **川崎 亮介, 桑田 英明, 井内 健介, 大宅 薫, 斉藤 美佐子, 林 輝幸, Jau Jack, 金井 健一 :** 電子ビーム照射による絶縁物薄膜の帯電と二次電子放出のシミュレーション, *LSIテスティングシンポジウム会議録,* 51-56, 2008年11月.
317. **清水 勝宏, 滝塚 知典, 大宅 薫, 井内 健介, 仲野 友英, 高山 有道, 川島 寿人 :** 非接触プラズマにおける不純物輸送のダイバータ統合モデリング, *プラズマ・核融合学会25回年会,* 2008年12月.
318. **井上 満夫, 井内 健介, 大宅 薫, 冨田 幸博, 河村 学思, 田辺 哲朗 :** 炭化水素のタイル再付着分布に及ぼすギャップ近傍のプラズマの影響, *プラズマ・核融合学会25回年会,* 2008年12月.
319. **茂原 直秀, 井内 健介, 大宅 薫, 菊原 康之, 伊藤 篤史, 中村 浩章, 田辺 哲朗 :** プラズマ対向壁に斜め入射する炭化水素の表面反射のMDシミュレーション, *プラズマ・核融合学会25回年会,* 2008年12月.
320. **大宅 薫 :** プラズマ対向壁の損耗・再堆積のシミュレーションの現状と展望, *未来エネルギー協会講演会,* 2008年12月.
321. **大宅 薫 :** プラズマ材料相互作用のシミュレーション研究, *PWI合同研究会,* 2008年12月.
322. **渡邊 隆之, 丸尾 洋一, 坂本 晃彦, 植野 貴大, 河村 亮輔, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** 対向ターゲット式DCマグネトロンスパッタリング法によりPET基板上に作製した酸化亜鉛-酸化インジウム系透明導電膜, *第47回セラミックス基礎科学討論会,* 2009年1月.
323. **宮田 侑是, 篠原 真毅, 三谷 友彦, 丹羽 直幹, 高木 賢二, 浜本 研一, 宇治 川智, 高橋 健介, 敖 金平, 大野 泰夫 :** GaNショットキーダイオードを用いた大電力レクテナの研究開発, *2009年電子情報通信学会総合大会,* 2009年3月.
324. **阿部 まみ, 奥山 祐加, 倉本 健次, 黒田 健太郎, 佐藤 弘明, 粟井 郁雄, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器無線接続における損失の検討, *2009年電子情報通信学会総合大会,* 2009年3月.
325. **成行 祐児, 松本 将和, 遠野 充明, 直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** ナノ加工を用いたGaNのC-V特性, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 30p-ZJ-3, 2009年3月.
326. **北村 政治, 川崎 晃一, 吉田 博紀, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** MOCVD法によるSi基板上へのSi1-x-yGexCy薄膜の成長, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 30p-E-6, 2009年3月.
327. **澤田 剛一, 敖 金平, 許 恒宇, 高橋 健介, 胡 成余, 河合 弘治, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 大野 泰夫 :** p型表面層を持つマイクロ波整流用GaNショットキーバリアダイオード, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
328. **井川 裕介, 湯浅 頼英, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETにおける仮想ゲート型電流コラプスのSPICE回路モデル, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
329. **胡 成余, 中谷 克俊, 敖 金平, 菊田 大悟, 杉本 雅裕, 大野 泰夫 :** p層上デュアルゲートAlGaN/GaN HFETにおけるアバランシェホール電流の測定, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
330. **井内 健介, 大宅 薫 :** castellation geometry タイル表面における炭化水素の再付着シミュレーション, *周辺プラズマモデリング研究会,* 2008年7月.
331. **胡 成余, 中谷 克俊, 敖 金平, 大野 泰夫, 菊田 大悟, 杉本 雅裕 :** VT-VSUB特性を用いたp-GaN上のAlGaN/GaN HFETバッファ層評価, *電気学会電子材料研究会,* 2008年11月.
332. **井川 裕介, 湯浅 頼英, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETのゲートエッジ負帯電による電流コラプスの2次元数値解析, *電気学会電子材料研究会,* 2008年11月.
333. **遠野 充明, 張 晶, 直井 美貴, 酒井 士郎, 和地 順蔵 :** ナノインプリント技術により周期的微細構造を施したGaN系デバイスからの電流注入発光特性, *電子情報通信学会電子デバイス研究会,* **Vol.ED2008-158,** 2008年11月.
334. **Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** Future Applications of GaN Electron Devices, *15th National conference on Compound Semiconductor Materials, Microwave Devices and Optoelectronic Devices (China),* Nov. 2008.
335. **Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Refractory Metal Nitride Schottky Contact on GaN, *15th National conference on Compound Semiconductor Materials, Microwave Devices and Optoelectronic Devices (China),* Nov. 2008.
336. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai *and* 菊原 康之 :** Simulation of Erosion and Redeposition on Plasma Facing Walls, *第7回統合コード研究会,* Dec. 2008.
337. **川上 烈生, 下村 直行, 富永 喜久雄, 井上 廉 :** 電気電子工学科における新入生の学業実態 ∼アンケート分析∼, *徳島大学工学部FD工学教育シンポジウム2009,* 27-33, 2009年3月.
338. **大野 泰夫 :** 共振器結合を用いたワイアレス電力伝送, *日本機械学会マイクロナノ工学専門会議マイクロエネルギー研究会第三回会合,* 2009年3月.
339. **川上 烈生 :** 紫外線LEDを利用した柑橘類の品質維持の可能性に関する研究, *財団法人 阿波銀行学術・文化振興財団,平成19年度(第12回)学術部門助成報告書,* 日本, 2008年4月.
340. **川上 烈生 :** ワイドギャップ半導体用の高性能・低コスト・ドライ洗浄装置の開発, *JSTイノベーションサテライト徳島,平成19年度研究成果実用化検討(FS)研究報告書,* 日本, 2008年4月.
341. **川上 烈生 :** 窒化物系半導体デバイスのためのプラズマ誘因ダメージレスナノプロセス装置の研究開発, *平成20年度教育研究等支援事業(学長裁量経費)報告書,* 日本, 2009年1月.
342. **川上 烈生 :** 高周波アルゴンプラズマによる衝撃粒子エネルギー分布と粒子束の解析, *平成20年度核融合科学研究所LHD数値解析システム利用共同研究報告書,* 日本, 2009年3月.
343. **川上 烈生 :** UV-LEDと光触媒のシナジー効果による果実の鮮度維持技術の開発研究, *徳島大学研究連携推進機構(知的財産本部),産学連携研究者育成支援事業,* 日本, 2009年3月.
344. **川上 烈生 :** UV-LEDによる光触媒酸化作用を用いた果実の汎用型鮮度維持装置の開発研究, *JSTイノベーションサテライト徳島,平成20年度シーズ発掘試験(A),* 日本, 2009年3月.
345. **Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** GaN-based Schottky Diodes, Handbook of Light Emitting and Schottky Diode Research, Nova Science Publishers, Hauppauge, May 2009.
346. **Kikuo Tominaga, Takashi Tsuzuki, Takayuki Maruyama, Michio Mikawa *and* Toshihiro Moriga :** Properties of Amorphous Transparent Conductive In-Ga-Zn Oxide Films Deposited on Fused Quartz by PLD Method, *e-Journal of Surface Science and Nanotechnology,* **Vol.7,** 273-276, 2009.
347. **Kensuke Takahashi, Jin-Ping Ao, Yusuke Ikawa, Cheng-Yu Hu, Hiroji Kawai, Naoki Shinohara, Naoki Niwa *and* Yasuo Ohno :** GaN Schottky Diodes for Microwave Power Rectification, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.4,* 04C095, 2009.
348. **Yuka Okuyama, Jin-Ping Ao, Ikuo Awai *and* Yasuo Ohno :** Wireless Inter-Chip Signal Transmission by Electromagnetic Coupling of Open-Ring Resonators, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.4,* 04C025, 2009.
349. **K. Shimizu, T. Takizuka, Kaoru Ohya, Kensuke Inai, T. Nakano, A. Takayama, H. Kawashima *and* K. Hoshino :** Kinetic modelling og impurity transport in detached plasma for integrated divertor simulation with SONIC (SOLDOR/NEUT2D/IMPMC/EDDY), *Nuclear Fusion,* **Vol.49,** *No.6,* 065028, 2009.
350. **Kikuo Tominaga, Kenji Okada, Yoshinori Miyamoto, Shinya Ohkura, Kazuya Kusaka, Kentaro Shiraishi, Takahiro Ueno *and* Takao Hanabusa :** Deposition of photocatalytic TiO2 films by planar magnetron sputtering system with opposed Ti targets, *e-Journal of Surface Science and Nanotechnology,* **Vol.7,** 290-293, 2009.
351. **Ryo Matsuoka, Takashi Okimoto, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** AlGaN epitaxial lateral overgrowth on Ti-evaporated GaN/sapphire substrate, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.311,** *No.10,* 2847-2849, 2009.
352. **Y. Ueda, M. Fukumoto, A. Yamawaki, Y. Soga, Y. Ohtsuka, S. Brezinsek, T. Hirai, A. Kirschner, A. Kreter, A. Litnovsky, V. Philipps, A. Pospieszczyk, B. Schweer, G. Sergienko, T. Tanabe, K. Sugiyama, Kaoru Ohya, N. Ohno *and* TEXTOR team :** Effects of tungsten surface conditions on carbon deposition, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.390-391,** 44-48, 2009.
353. **Daiji Kato, Takahiro Kenmotsu, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Excited state distribution of reflected hydrogen atoms at metal surfaces - Development of theoretical models, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.390-391,** 498-501, 2009.
354. **Kaoru Ohya, Y. Kikuhara, Kensuke Inai, A. Kirschner, D. Borodin, A. Ito, H. Nakamura *and* T. Tanabe :** Simulation of hydrocarbon reflection from carbon and tungsten surfaces and its impact on codeposition patterns on plasma facing components, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.390-391,** 72-75, 2009.
355. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya, Y. Tomita, A. Kirschner, A. Litnovsky *and* T. Tanabe :** Simulation of redeposition of carbon/hydrocarbon on a material surface with castellated structures, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.390-391,** 119-122, 2009.
356. **K. Hoshino, M. Toma, M. Furubayashi, A. Hatayama, Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Numerical analysis of incident angle of heavy metal impurity to plasma facing components by IMPGYRO, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.390-391,** 168-171, 2009.
357. **M. Toma, K. Hoshino, Kensuke Inai, M. Furubayashi, A. Hatayama *and* Kaoru Ohya :** Coupled IMPGYRO-EDDY simulation of tungsten impurity transport in tokamak geometry, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.390-391,** 207-210, 2009.
358. **A. Yamawaki, M. Fukumoto, Y. Soga, Y. Ueda *and* Kaoru Ohya :** Temperature dependence of carbon deposition on tungsten, *Fusion Science and Technology,* **Vol.56,** *No.2,* 1038-1042, 2009.
359. **Retsuo Kawakami, Takeshi Inaoka, Kikuo Tominaga *and* Mukai Takashi :** Effects of Capacitively Coupled Radio Frequency Krypton and Argon Plasmas on Gallium Nitride Etching Damage, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.48,** *No.8,* 08HF01-1-08HF01-4, 2009.
360. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya, G. Kawamura *and* Y. Tomita :** An EDDY-PIC Simulation of Co-deposition of Hydrogen Isotopes on a Castellated Structure of Plasma Facing Tiles, *Journal of Plasma and Fusion Research Series,* **Vol.8,** 433-437, 2009.
361. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Y. Kikuhara, T. Nakano, J. Kawata, H. Kawazome, Y. Ueda *and* T. Tanabe :** Transport of Heavy Hydrocarbon and its Redeposition on Plasma Facing Walls, *Journal of Plasma and Fusion Research Series,* **Vol.8,** 419-424, 2009.
362. **M. Toma, K. Hoshino, Kensuke Inai, M. Ishida, A. Hatayama *and* Kaoru Ohya :** Analysis of the high-Z impurity transport in a Tokamak by the IMPGYRO code, *Journal of Plasma and Fusion Research Series,* **Vol.8,** 1116-1119, 2009.
363. **Jing Zhang, Yoshiki Naoi, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** Fabrication and Photovoltaic Measurements of Surface Nanostructure of AlGaInN-Based Photodetector, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.48,** *No.11,* 111001-1-111001-5, 2009.
364. **Kaoru Ohya *and* Andreas Kirschner :** Modeling of erosion and deposition by the Monte Carlo codes EDDY and ERO, *Physica Scripta,* **Vol.T138,** 014010-(7pp), 2009.
365. **Andreas Kirschner, Kaoru Ohya, D. Borodin, R. Ding, D. Matveev, V. Philipps *and* U. Samm :** Prediction of long-term tritium retention in the divertor of ITER: influence of modelling assumptions on retention rates, *Physica Scripta,* **Vol.T138,** 014011-(6pp), 2009.
366. **M. Sakamoto, T. Miyazaki, Y. Higashizono, K. Ogawa, K. Ozaki, N. Ashikawa, M. Tokitani, T. Shoji, S. Masuzaki, K. Tokunaga, Kaoru Ohya, A. Sagara, N. Yoshida *and* K.N. Sato :** Surface modification of tungsten mirrors due to low-energy helium plasma irradiation in the compact PWI simulator APSEDAS, *Physica Scripta,* **Vol.T138,** 014043-(5pp), 2009.
367. **Tohru Ishitani, Takuya Yamanaka, Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Secondary electron emission in scanning Ga ion, He ion and electron microscope, *Vacuum,* **Vol.84,** *No.8,* 1018-1024, 2010.
368. **Daiji Kato, Takahiro Kenmotsu, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Linear polarization of photon emission from reflected neutrals of atomic hydrogen at metal PFCs, *Research Report of National Institute for Fusion Science, No.NIFS-PROC-81,* 150-161, 2010.
369. **Yuta Higashizono, Mizuki Sakamoto, Toshimasa Miyazaki, Kazuma Ogawa, Kazuki Ozaki, Yousuke Nakashima, Tatsuo Shoji, Naoko Ashikawa, Masayuki Tokitani, Kazutoshi Tokunaga, Suguru Masuzaki, Kaoru Ohya, Akio Sagara *and* Kohnosyke Sato :** Axial Profile of Balmer-Alpha Emission near a Tungsten Target in the Compact PWI Simulator APSEDAS, *Plasma and Fusion Research,* **Vol.4,** *No.0,* 043-1-043-3, 2009.
370. **大宅 薫, 井内 健介, 清水 勝宏, 滝塚 知典, 川島 寿人, 星野 一生, 畑山 明聖, 藤間 光徳, 冨田 幸博, 河村 学思, 芦川 直子, 田中 康規, 小野 忠良, 村本 哲也, 剣持 貴弘, 中村 浩章, 伊藤 篤史, 加藤 太治 :** 核融合炉のトリチウム蓄積・排出評価のための理論およびシミュレーションコードの開発, *プラズマ・核融合学会誌,* **Vol.85,** *No.10,* 695-703, 2009年10月.
371. **Kikuo Tominaga, Akihiko Sakamoto, Takayuki Watanabe *and* Toshihiro Moriga :** Effects of low-temperature and short-time annealing on amorphous transparent conductive oxide IZO (In2O3-ZnO) films, *6th International Symposium on Transparent Oxide Thin Films for Electronics and Optics (TOEO-6),* 75, Tokyo, Apr. 2009.
372. **M Sakamoto, T Miyazaki, Y Higashizono, K Ogawa, K Ozaki, N Ashikawa, M Tokitani, T Shoji, S Masuzaki, K Tokunaga, Kaoru Ohya, A Sagara, N Yoshida *and* KN Sato :** Surface modification of tungsten due to plasma irradiation in the compact PWI simulator APSEDAS, *12th International Workshop on Plasma Facing Materials and Components for Fusion Applications,* Juelich, Germany, May 2009.
373. **Kaoru Ohya *and* Andreas Kirschner :** Modeling of erosion and deposition by the Monte Carlo codes EDDY and ERO, *12th International Workshop on Plasma Facing Materials and Components for Fusion Apprications,* Juelich, Germany, May 2009.
374. **Andreas Kirschner, Kaoru Ohya, D Borodin, R Ding, D Matveev, V Philipps *and* U Samm :** Prediction of long-term tritium retention in the divertor of ITER: influence of modelling assumptions on retention rates, *12th International Workshop on Plasma Facing Materials and Components for Fusion Applications,* Juelich, Germany, May 2009.
375. **Atsushi Ito, Takahiro Kenmotsu, Yasuyuki Kikuhara, Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Y. Wang, S. Irle, K. Morokuma *and* Hiroaki Nakamura :** Hydrogen atom injection into carbon surfaces by comparison between Monte-Carlo, molecular dynamics and ab-initio calculations, *4th IAEA Technical Meeting (IAEA-TM) on the Theory of Plasma Instabilities,* Kyoto, May 2009.
376. **Jing Zang, S. Okuno, Yoshiki Naoi, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** The surface nanostructure photo-voltaic property of GaN-based photodetector, *Asia-Pacific Workshop on wide gap Semiconductors (APWS 2009),* MO3-7, Zhangjiajie, May 2009.
377. **Kaoru Ohya :** Integrated numerical simulations and modelling of erosion and deposition on plasma facing wall, *THIRD ITER SUMMER SCHOOL: Plasma Surface Interaction in Controlled Fusion Devices,* Aix en Provence, France, Jun. 2009.
378. **Retsuo Kawakami, Kikuo Tominaga, Okada Kenji, Nouda Takahiro, Takeshi Inaoka, Takeichi Atsushi, Fukudome Toshiaki *and* Murao Kenichi :** Etch Damage Characteristics of TiO2 Thin Films by Capacitively Coupled RF Ar Plasmas, *Proceedings of 10th International Symposium of Sputtering & Plasma Processes,* 500-503, Kanazawa, Jul. 2009.
379. **Jin-Ping Ao, Asato Suzuki, Kouichi Sawada, Satoko Shinkai *and* Yasuo Ohno :** Schottky Contacts of Reactive Sputtering Refractory Metal Nitrides on Gallium Nitride, *The 10th International Symposium on Sputtering & Plasma Processes,* 433-436, Kanazawa, Jul. 2009.
380. **Nouda Takahiro, Tominaga Kikuo, Okada Kenji, Murao Ken-ichi, Retsuo Kawakami, Kusaka Kazuya *and* Hanabusa Takao :** Deposition and characterization of TiO2 thin films by rf-dc coupled reactive magnetron sputtering, *Proceedings of 10th International Symposium of Sputtering & Plasma Processes,* 479-482, Kanazawa, Jul. 2009.
381. **Atsushi Ito, Takahiro Kanmotsu, Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Y. Wang, S. Irle, K. Morokuma *and* Hiroaki Nakamura :** Hydrogen atom and graphite surfaces interaction by molecular dynamics, Monte-Carlo and ab-initio calculations, *CREST International Symposium on Theory and Simulations of Complex Molecular System & International Symposium on Theory of Molecular Structure,* Kyoto, Jul. 2009.
382. **Kaoru Ohya :** Coupled EDDY/MD/PIC modeling of erosion and deposition on plasma facing walls, *2009 Japan-U.S. Workshop on Heat Removal and Plasma Material Interactions for Fusion, Fusion High Power Density Components and Systems, and IEA Workshop on Solid Surface Plasma Facing Components,* Berkeley, California, USA, Jul. 2009.
383. **Cheng-Yu Hu, Katsutoshi Nakatani, Hiroji Kawai, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Buffer layer doping concentration measurement using VT-VSUB Characterization of GaN HEMT with p-GaN substrate layer, *8th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Nagano, Aug. 2009.
384. **Yusuke Ikawa, Yorihide Yuasa, Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** 2D Device Simulation of AlGaN/GaN HFET Current Collapse Caused by Surface Negative Charge Injection, *8th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Nagano, Aug. 2009.
385. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya, Gakushi Kawamura *and* Yukihiro Tomita :** Electron velocity distribution at a sheath edge in the presence of secondary electron emission from a metal surface, *12th International Workshop on Plasma Edge Theoty in Fusion Devices,* Rostov Veliky, Russia, Sep. 2009.
386. **Daiji Kato, Takahiro Kenmotsu, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Linear polarization of photons emitted from excited hydrogen atoms formed above metal surfaces, *12th International Workshop on Plasma Edge Theory in Fusion Devices,* Rostov Veliky, Russia, Sep. 2009.
387. **Atsushi Ito, Kaoru Ohya, Kensuke Inai *and* Hiroaki Nakamura :** Dependency of tritium retention in graphite on temperature control of molecular dynamics, *12th International Workshop on Plasma Edge Theory in Fusion Devices,* Rostov Veliky, Russia, Sep. 2009.
388. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya, Mitsuo Inoue, Yukihiro Tomita, Gakushi Kawamura *and* Tetsuo Tanabe :** Asymmetric Carbon Deposition in Toroidal and Poloidal Gaps of Plasma Facing Tiles, *14th International Conference on Fusion Reactor Materials,* Sapporo, Sep. 2009.
389. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Yasuyuki Kikuhara, Naohide Mohara, Atsushi Ito, Hiroaki Nakamura *and* Tetsuo Tanabe :** Molecular Dynamics Study on Hydrocarbon Interactions with Plasma Facing Walls, *14th International Conference on Fusion Reactor Materials,* Sapporo, Sep. 2009.
390. **Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo, Niibe Masahito, Mukai Takashi, Takeichi Atsushi *and* Fukudome Toshiaki :** Synergy Effect of Xenon Plasma Ions and Ultraviolet Lights on GaN Etch Surface Damage and Modification, *16th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams,* 190, Tokyo, Sep. 2009.
391. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Ryosuke Kawasaki, Daiki Takami, Misako Saito, Teruyuki Hayashi, J. Jau *and* K. Kanai :** Modeling and Observations of Electron Beam Charging of an Insulator/Metal Bilayer and Its Impact on Secondary Electron Images in Defect Inspection Equipment, *Thw Twelfth Frontiers of Electron Microscopy in Materials Science,* Huis Ten Bosch, Sasebo, Japan, Sep. 2009.
392. **Cheng-Yu Hu, Hiroyuki Nokubo, Masaya Okada, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** MIS Diode Characterization on n-GaN by C-V Measurement at 150 C, *The 2009 International Conference on Solid State Devices and Materials,* Sendai, Oct. 2009.
393. **Katsutoshi Nakatani, Jin-Ping Ao, Keisuke Ohmuro, Masahiro Sugimoto, Cheng-Yu Hu, Yuji Sogawa *and* Yasuo Ohno :** Evaluation of GaN MOSFET with TEOS SiO2 Gate Insulator, *The 2009 International Conference on Solid State Devices and Materials,* Sendai, Oct. 2009.
394. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Naohide Mohara, Yohei Miyake, Atsushi Ito, Hiroaki Nakamura, D. Borodin *and* Andreas Kirschner :** Molecular Dynamics and Dynamic Monte Carlo Study of Mixed Material and Its Impact on Plasma Wall Interactions, *9th International Symposium on Fusion Nuclear Technology,* Dalian, China, Oct. 2009.
395. **Kensuke Inai, Yukihiro Tomita, Mitsuo Inoue, Gakushi Kawamura *and* Kaoru Ohya :** A Coupled PIC/ELECTRAN Simulation of Sheath Formation with Secondary Electron Emission from Plasma Facing Walls, *9th International Symposium on Fusion Nuclear Technology,* Dalian, China, Oct. 2009.
396. **Cheng-Yu Hu, Daigo Kikuta, Katsutoshi Nakatani, Jin-Ping Ao, Masahiro Sugimoto *and* Yasuo Ohno :** Low Resistance Ohmic Contact to Deeply Dry-etched p-GaN, *The 8th International Conference on Nitride Semiconductors,* Cheju, Oct. 2009.
397. **Cheng-Yu Hu, Daigo Kikuta, Katsutoshi Nakatani, Jin-Ping Ao, Masahiro Sugimoto *and* Yasuo Ohno :** Monitoring and control of substrate voltage for AlGaN/GaN HEMTs with p-GaN epi-layer, *The 8th International Conference on Nitride Semiconductors,* Cheju, Oct. 2009.
398. **Kohei Hara, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** GaN Re-growth Using Ta Mask by Metalorganic Chemical Vapor Deposition, *The 8th International Conference on Nitride Semiconductors,* MP9, Cheju, Oct. 2009.
399. **Takesi Noda, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Crack Reduction of AlGaN on GaN/sapphire by Metalorganic Chemical Vapor Deposition, *The 8th International Conference on Nitride Semiconductors,* MP14, Cheju, Oct. 2009.
400. **Yuji Nariyuki, Masakazu Matsmoto, Yoshiki Naoi, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** Evaluation and Re-growth of GaN on Nano-patterned GaN on a Sapphire Substrate, *The 8th International Conference on Nitride Semiconductors,* TP113, Cheju, Oct. 2009.
401. **Jing Zhang, Yoshiki Naoi, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** GaN Surface Nanostructure Photodetector Based on Back Side Incidence, *The 8th International Conference on Nitride Semiconductors,* TP145, Cheju, Oct. 2009.
402. **Yoshiki Naoi, Mitsuaki Tohno, Tianya Tan, Masakazu Matsmoto, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** GaN-bsed Light Emitting Diodes with Periodic Nano-structues on the Surface Fabricated by Nanoimprint Lithography Technique, *The 8th International Conference on Nitride Semiconductors,* ThP106, Cheju, Oct. 2009.
403. **M. Sakamoto, Y. Higashizono, T. Miyazaki, K. Ozaki, K. Ogawa, N. Ashikawa, M. Tokitani, T. Shoji, S. Masuzaki, K. Tokunaga, Kaoru Ohya, A. Sagara, N. Yoshida *and* K.N. Sato :** Surface modification of tungsten irradiated by low energy plasma in the compact PWI simulator APSEDAS, *7th General Scientific Assembly of the Asia Plasma and Fusion Association in 2009 and Asia-Pacific Plasma Theory Conference in 2009,* Aomori, Oct. 2009.
404. **Kaoru Ohya, Naohide Mohara, Yohei Miyake, Kensuke Inai, Atsushi Ito, Hiroaki Nakamura, Yoshio Ueda *and* Tetsuo Tanabe :** Molecular dynamics study of plasma surface interactions for mixed materials, *7th General Scientific Assembly of the Asia Plasma and Fusion Association in 2009 and Asia-Pacific Plasma Theory Conference in 2009,* Aomori, Oct. 2009.
405. **Hayato Kawazome, Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Jun Kawata, Kenji Nishimura *and* Tetsuo Tanabe :** Calculation of D/XB values of hydrocarbon molecules in tokamak edge plasmas, *19 th International Toki Conference (ITC-19) on Advanced Physics in Plasma and Fusion Research,* Toki, Japan, Dec. 2009.
406. **M. Sakamoto, Y. Higashizono, H. Zushi, K. Nakamura, K. Hanada, H. Idei, K. Tokunaga, M. Hasegawa, S. Kawasaki, H. Nakashima, T. Fujiwara, A. Higashijima, T. Miyazaki, K. Ozaki, K. Ogawa, M. Tokitani, M. Miyamoto, N. Ashikawa, T. Shoji, S. Masuzaki, Kaoru Ohya, A. Sagara, N. Yoshida *and* K.N. Sato :** Plasma-Wall Interaction Study towards the Steady State Operation, *19th International Toki Conference (ITC-19) on Advanced Physics in Plasma and Fusion Research,* Toki, Japan, Dec. 2009.
407. **Koji Kawasaki, Seiji Kitamura, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Growth of SiGeC Thin Film on Si Substrate by Metal Organic Chemical Vaoir Deposition, *Fifth International Workshop on NEW GROUP IV SEMICONDUCTOR NANOELECTRONICS,* P-09, Sendai, Jan. 2010.
408. **Kohei Hara, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Ta-etching of GaN by the Metalorganic Chemical Vapor Deposition-re-growth of GaN, *2nd International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials,* PB055B, Nagoya, Mar. 2010.
409. **Jing Zhang, Takumi Taoka, Yoshiki Naoi, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** Front and Back Side Illumination of a Nano-Structured AlGaInN Photodetector, *2nd International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials,* PB064C, Nagoya, Mar. 2010.
410. **野田 丈嗣, 松岡 遼, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** MOCVD-GaN on Sapphire上AlGaNのクラックの低減に関する研究, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 1a-ZJ-14, 2009年4月.
411. **張 晶, 遠野 充明, 奥野 誠亮, 直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** GaNナノ加工pnダイオード光検出器, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 1a-ZJ-30, 2009年4月.
412. **直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚, 納田 卓, 木村 真大, 川野 俊輔, 村本 宜彦 :** サファイア上周期的ナノ構造を形成するためのナノインプリント技術開発とGaN系LED, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 1p-ZJ-10, 2009年4月.
413. **遠野 充明, 直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** ナノインプリント技術により周期的ナノ構造を形成したGaN系光デバイスからのEL特性, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 1p-ZJ-11, 2009年4月.
414. **黒田 健太郎, 井川 裕介, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET電流コラプスのステップストレス測定, *第70回応用物理学会学術講演会,* 2009年9月.
415. **下村 輝, 粟井 郁雄, 大野 泰夫 :** ミリはインターコネクトにおける設置面の影響, *2009年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2009年9月.
416. **高橋 健介, 敖 金平, 胡 成余, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 大野 泰夫 :** マイクロ波電力整流用GaNショットキーダイオードのSパラメータ解析, *2009年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2009年9月.
417. **倉本 健次, 阿部 まみ, 奥山 祐加, 敖 金平, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器を用いた非接触広帯域入出力インターフェイス, *2009年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2009年9月.
418. **阿部 まみ, 倉本 健次, 敖 金平, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器無線接続における基板抵抗の影響, *2009年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2009年9月.
419. **成行 祐児, 松本 将和, 直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** ナノ加工を施したGaN上への再成長及びその評価, *第70回応用物理学会学術講演会,* 8p-F-2, 2009年9月.
420. **新部 正人, 前田 佳恵, 川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** ArおよびKrでRFプラズマエッチングしたGaN結晶の表面組成分析, *第70回秋季応用物理学会学術講演会論文集, No.1,* 189, 2009年9月.
421. **川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 新部 正人, 向井 孝志 :** 容量結合型KrプラズマによるGaNエッチングダメージ解析, *第70回秋季応用物理学会学術講演会論文集, No.1,* 188, 2009年9月.
422. **張 晶, 直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** 裏面入射GaN系表面ナノ構造光検出器, *第70回応用物理学会学術講演会,* 10a-E-9, 2009年9月.
423. **原 航平, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** Taマスクを用いた下地層エッチングによるGaN再成長, *第70回応用物理学会学術講演会,* 11a-E-9, 2009年9月.
424. **野田 丈嗣, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** MOCVD-GaN on Sapphire上AlGaNのクラックの低減に関する研究(2), *第70回応用物理学会学術講演会,* 11a-E-10, 2009年9月.
425. **直井 美貴, 松本 将和, 譚 天亜, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** 表面ナノ周期構造を有するInGaN-LEDからの輻射光空間分布特性, *第70回応用物理学会学術講演会,* 11a-X-8, 2009年9月.
426. **丸尾 洋一, 大森 悠丘, 渡邊 隆之, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** 有機高分子基板上に製膜したZnO-In2O3系, *日本材料学会四国支部 第6回夏季材料セミナー,* 2009年9月.
427. **稲岡 武, 川上 烈生, 富永 喜久雄, 新部 正人, 向井 孝志 :** 非対称放電系容量結合型RFクリプトンプラズマの放電及び発光特性, *平成21年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 30, 2009年9月.
428. **川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 新部 正人, 向井 孝志 :** クリプトンとアルゴンプラズマによる窒化ガリウムエッチングダメージ, *平成21年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 29, 2009年9月.
429. **大宅 薫, 茂原 直秀, 井内 健介, 伊藤 篤史, 中村 浩章, 上田 良夫, 田辺 哲朗 :** プラズマ対向壁に形成される混合層スパッタリングのシミュレーション, *プラズマ・核融合学会第26回年会,* 2009年12月.
430. **新部 正人, 前田 佳恵, 川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** プラズマエッチングしたGaN結晶のN-K吸収測定によるダメージ解析, *第23回日本放射光学会年会,* 2010年1月.
431. **大野 泰夫 :** 無線送電とワイドギャップ半導体, *2010年電子情報通信学会総合大会,* 2010年3月.
432. **阿部 まみ, 倉本 健次, 天羽 孝文, 敖 金平, 大野 泰夫 :** 誘電率の異なる基板間でのオープンリング共振器無線接続, *2010年電子情報通信学会総合大会,* 2010年3月.
433. **大宅 薫 :** 炭素再堆積層におけるプラズマ・壁相互作用のシミュレーション, *「マルチスケールでのプラズマ・壁相互作用の理解」研究会,* 2010年3月.
434. **西野 克志, 澤井 佑介, 成行 祐児, 野田 丈嗣, 直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** ナノ加工GaN基板上再成長層のTEM観察, *第57回応用物理学関係連合講演会,* 19a-TB2, 2010年3月.
435. **中谷 克俊, 祖川 雄司, 金 栄現, 敖 金平, 大野 泰夫, 宮下 準弘, 本山 慎一 :** プラズマCVD酸化膜を用いたGaN MOSFET, *第57回応用物理学関係連合講演会,* 2010年3月.
436. **黒田 健太郎, 井川 裕介, 光山 健太, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET電流コラプスにおける光照射の影響, *第57回応用物理学関係連合講演会,* 2010年3月.
437. **直井 美貴 :** LEDの光出力改善技術, *技術情報協会:LED照明の高輝度・長寿命化技術セミナー,* 2009年5月.
438. **大野 泰夫 :** 化合物半導体電子デバイス開発の軌跡, *電子情報通信学会シリコン材料・デバイス研究会資料,* 2009年6月.
439. **野崎 兼史, 高橋 義也, 敖 金平, 大野 泰夫 :** オープンゲートAlGaN/GaN HFETの電解質溶液を介した電流制御, *電子情報通信学会センサーデバイス・MEMS・一般研究会,* 2009年7月.
440. **下村 直行, 川上 烈生, 寺西 研二, 富永 喜久雄 :** 導入教育・初年度教育に関する考察, --- 徳島大学電気電子工学科のアンケート結果から ---, *電気学会研究会資料,* **Vol.FIE-09,** *No.3,* 41-46, 2009年8月.
441. **直井 美貴 :** 紫外線LEDの開発動向と今後の応用について, *徳島ビジネスチャレンジメッセ2009 LEDコンソーシアム基調講演,* 2009年10月.
442. **新部 正人, 前田 佳恵, 川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** プラズマエッチングしたGaN結晶のN-K吸収計測によるダメージ解析, *第45回X線分析討論会,* 2009年11月.
443. **川上 烈生 :** UV-LEDによる光触媒酸化作用を用いた果実の汎用型鮮度維持装置の開発研究, *第三回技術シーズ発表会 in 四国 ∼四国発!地域元気の取組みについて∼,* 2009年11月.
444. **黒田 健太郎, 井川 裕介, 光山 健太, 敖 金平, 大野 泰夫 :** ステップストレス測定によるAlGaN/GaN HFET電流コラプス解析, *電子情報通信学会電子デバイス，電子部品・材料，レーザ・量子エレクトロニクス研究会,* 2009年11月.
445. **高橋 健介, 敖 金平, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 藤原 暉雄, 大野 泰夫 :** マイク ロ波無線ユビキタス電源用GaNショットキーダイオードの開発, *電子情報通信学会電子デバイス，電子部品・材料，レーザ・量子エレクトロニクス研究会,* 2009年11月.
446. **原 航平, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** Taマスクを用いた下地層エッチングによるGaN再成長, *電子情報通信学会電子デバイス研究会,* **Vol.109,** *No.288,* 1-4, 2009年11月.
447. **張 晶, 直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** GaN系表面ナノ構造光検出器, *電子情報通信学会電子デバイス研究会,* **Vol.109,** *No.288,* 83-87, 2009年11月.
448. **Y.J. Choi, Yoshiki Naoi, Kohei Hara, Masakzu Matsumoto, Shiro Sakai *and* S.N. Yi :** GaN nanorod fabrication by reactive ion etching and nanoimprint lithography technique, *Proceedings of the fourth symposium on "The Fourth International Symposium:Development of the Global Doble Degree Program(GDPP)",* 54, Dec. 2009.
449. **川上 烈生 :** 果実の汎用型鮮度維持装置, *STイノベーションサテライト徳島 育成研究報告会 平成18年度採択育成研究課題報告,* 2009年12月.
450. **新部 正人, 前田 佳恵, 川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** プラズマエッチングしたGaN結晶のNEXAFS測定によるダメージ解析, *2010先端技術セミナー，高度産業科学技術研究所主催,* 2010年3月.
451. **西野 克志, 直井 美貴 :** 電気電子工学科基礎科目における再履修生を対象とした授業の試み, *工学教育シンポジウム2010(SEE2010),* 2010年3月.
452. **川上 烈生 :** 高周波クリプトンプラズマによる自己無撞着な衝撃粒子エネルギー分布及び粒子束の解析, *平成21年度核融合科学研究所LHD数値解析システム利用共同研究報告書,* 日本, 2010年3月.
453. **川上 烈生 :** UV-LEDによる薄膜系TiO2の光触媒反応活性化のための大気圧空気プラズマナノ表面処理技術の開発研究, *徳島大学研究連携推進機構(知的財産本部),産学連携研究者育成支援事業,* 日本, 2010年3月.
454. **川上 烈生 :** 分光計測(反射・透過・膜厚)システム一式, *徳島大学外部資金に係わる間接経費(学長裁量経費),* 日本, 2010年3月.
455. **Kaoru Ohya :** Plasma Interaction in Controlled Fusion Devices: 3rd ITER International Summer School, American Institute of Physics, Jun. 2010.
456. **Cheng-Yu Hu, Hiroyuki Nokubo, Masanari Okada, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Metal Insulator Semiconductor Diode Characterization on n-GaN by Capacitance Voltage Measurement at 150 °C, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.49,** *No.4,* 04DF11, 2010.
457. **Jin-Ping Ao, Katsutoshi Nakatani, Keisuke Ohmuro, Masahiro Sugimoto, Cheng-Yu Hu, Yuji Sogawa *and* Yasuo Ohno :** GaN Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor with Tetraethylorthosilicate SiO2 Gate Insulator on AlGaN/GaN Heterostructure, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.49,** *No.4,* 04DF09-1-04DF09-4, 2010.
458. **Jing Zhang, Yoshiki Naoi, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** GaN surface nanostructure photodetector based on back side incidence, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.7,** *No.7-8,* 1804-1806, 2010.
459. **Daiji Kato, Takahiro Kenmotsu, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Linear Polarization of Photons Emitted from Excited Hydrogen Atoms Formed above Metal Surfaces, *Contributions to Plasma Physics,* **Vol.50,** *No.3-5,* 445-450, 2010.
460. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya, Gakushi Kawamura *and* Yukihiro Tomita :** Electron Velocity Distributions at a Sheath Edge in the Presence og Secondary Electron Emission from a Metal Surface, *Contributions to Plasma Physics,* **Vol.50,** *No.3-5,* 458-463, 2010.
461. **Atsushi Ito, Kaoru Ohya, Kensuke Inai *and* Hiroaki Nakamura :** Dependency of Tritium Retention in Graphite on Temperature Control of Molecular Dynamics, *Contributions to Plasma Physics,* **Vol.50,** *No.3-5,* 464-469, 2010.
462. **Yuji Nariyuki, Masakazu Matsumot, Takeshi Noda, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** Evaluation and re-growth of p-GaN on nano-patterned GaN on sapphire substrate, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.7,** *No.7-8,* 2121-2123, 2010.
463. **Yoshiki Naoi, Masakazu Matsumot, Tianya Tan, Mitsuaki Tohno, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** GaN-based light emitting diodes with periodic nano-structures on the surface fabricated by nanoimprint lithography technique, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.7,** *No.7-8,* 2154-2156, 2010.
464. **Retsuo Kawakami, Tominaga Kikuo, Okada Kenji, Nouda Takahiro, Inaoka Takeshi, Takeichi Atsushi, Fukudome Toshiaki *and* Murao Kenichi :** Etch Damage Characteristics of TiO2 Thin Films by Capacitively Coupled RF Ar Plasmas, *Vacuum,* **Vol.84,** *No.12,* 1393-1397, 2010.
465. **Jin-Ping Ao, Asato Suzuki, Kouichi Sawada, Satoko Shinkai, Yoshiki Naoi *and* Yasuo Ohno :** Schottky contacts of refractory metal nitrides on gallium nitride using reactive sputtering, *Vacuum,* **Vol.84,** *No.12,* 1439-1443, 2010.
466. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Ryosuke Kawasaki, Misako Saito, Teruyuki Hayashi, Jack Jau *and* Kenichi Kanai :** Modelling and observations of electron beam charging of an insulator/metal bilayer and its impact on secondary electron images in defect inspection equipment, *Journal of Electron Microscopy,* **Vol.59,** S189-S193, 2010.
467. **Kaoru Ohya, Naohide Mohara, Kensuke Inai, Atsushi Ito, Hiroaki Nakamura, Yoshio Ueda *and* Tetsuo Tanabe :** Molecular Dynamics Study of Plasma Surface Interactions for Mixed Materials, *Journal of Plasma and Fusion Research SERIES,* **Vol.9,** 497-502, 2010.
468. **Kaoru Ohya, MOHARA Naohide, Kensuke Inai, ITO Atsushi, NAKAMURA Hiroaki, UEDA Yoshio *and* TANABE Tetsuo :** Molecular Dynamics Study of Plasma Surface Interactions for Mixed Materials, *J. Plasma Fusion Res. SERIES,* **Vol.9,** 497-502, 2010.
469. **Kaoru Ohya *and* Kensuke Inai :** Hydrocarbon Redeposition on Plasma Facing Walls Intersecting Magnetic Field at Shallow Angles, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.49,** *No.9,* 096201-1-096201-7, 2010.
470. **Yusuke Ikawa, Yorihide Yuasa, Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** 2D Device Simulation of AlGaN/GaN HFET Current Collapse Caused by Surface Negative Charge Injection, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E93-C,** *No.8,* 1218-1224, 2010.
471. **Cheng-Yu Hu, Katsutoshi Nakatani, Hiroji Kawai, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Buffer Layer Doping Concentration Measurement Using VT-VSUB Characteristics of GaN HEMT with p-GaN Substrate Layer, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E93-C,** *No.8,* 1234-1237, 2010.
472. **Kensuke Inai, Yukihiro Tomita, Gakushi Kawamura *and* Kaoru Ohya :** A coupled EDDY/PIC/ELECTRAN simulation of erosion and deposition in gaps, *Fusion Engineering and Design,* **Vol.85,** *No.7-9,* 1416-1420, 2010.
473. **Kaoru Ohya, Naohide Mohara, Kensuke Inai, Atsushi Ito, Hiroaki Nakamura, Andreas Kirschner *and* Dimitry Borodin :** Molecular dynamics and dynamic Monte Carlo studies of mixed materials and their impact on plasma wall interactions, *Fusion Engineering and Design,* **Vol.85,** *No.7-9,* 1167-1172, 2010.
474. **Hayato Kawazome, Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Jun Kawata, Kenji Nishimura *and* Tetsuo Tanabe :** Calculation of D/XB Values of Hydrocarbon Molecules in Tokamak Edge Plasmas, *Plasma and Fusion Research,* **Vol.5,** S2073-1-S2073-5, 2010.
475. **Jin-Ping Ao :** Monolithic Integration of GaN-based LEDs, *Journal of Physics: Conference Series,* **Vol.276,** *No.1,* 012001-1-012001-4, 2011.
476. **Retsuo Kawakami, Niibe Masahito, Fukudome Toshiaki, Takeichi Atsushi, Inaoka Takeshi *and* Tominaga Kikuo :** Effect of DBD Air Plasma Treatment on TiO2 Thin Film Surfaces, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.50,** *No.1,* 01BE02-1-01BE02-5, 2011.
477. **Jin-Ping Ao, Katsutoshi Nakatani, Yuji Sogawa, Shiro Akamatsu, Young Hyun Kim, Takahiro Miyashita, Shin-ichi Motoyama *and* Yasuo Ohno :** GaN MOSFET with a gate SiO2 insulator deposited by silane-based plasma-enhanced chemical vapor deposition, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.8,** *No.2,* 457-460, 2011.
478. **Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo, Niibe Masahito, Mukai Takashi, Takeichi Atsushi *and* Fukudome Toshiaki :** Etch-induced damage characteristics of n-GaN surfaces by capacitively coupled radio frequency He and Ar plasmas, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.8,** *No.2,* 441-443, 2011.
479. **Niibe Masahito, Maeda Yoshie, Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo *and* Mukai Takashi :** Surface analysis of n-GaN crystal damaged by RF-plasma-etching with Ar, Kr, and Xe gases, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.8,** *No.2,* 435-437, 2011.
480. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** An EDDY/Particle-in-Cell Simulation of Erosion of Plasma Facing Walls Bombarded by a Collisional Plasma, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.50,** *No.2,* 026001-1-026001-7, 2011.
481. **Kaoru Ohya *and* Hideaki Kuwada :** Modeling of Electron Beam Charging of an Insulating Layer on a Silicon Substrate, *e-Journal of Surface Science and Nanotechnology,* **Vol.9,** 112-116, 2011.
482. **Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo, Niibe Masahito, Mukai Takashi, Takeichi Atsushi *and* Fukudome Toshiaki :** Synergy Effect of Xenon Plasma Ions and Ultraviolet Lights on GaN Etch Surface Damage and Modification, *Transactions of the Materials Research Society of Japan,* **Vol.36,** *No.1,* 75-78, 2011.
483. **大宅 薫, Andreas Kirschner :** 国際連携による核融合炉実現を目指したプラズマ対向炉材料寿命評価コードの開発, *徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告, No.55,* 31-36, 2010年.
484. **Kaoru Ohya, Takuya Yamanaka, Daiki Takami *and* Kensuke Inai :** Modeling of charging effects in scanning ion microscopes, *Proceedings of SPIE,* **Vol.7729,** 7729-24-(9pp), Monterey, May 2010.
485. **Kaoru Ohya :** Progress in Modeling Plasma-Material Interactions, *19th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* San Diego, California, USA, May 2010.
486. **Y. Higashizono, M. Sakamoto, K. Ogawa, K. Ozaki, S. Tsuru, R. Ohyama, I. Gouda, T. Shoji, N. Ashikawa, M. Tokitani, K. Tokunaga, S. Masuzaki, Kaoru Ohya, A. Sagara *and* K.N. Sato :** Plasma and Neutral Hydrogen Behavior near Plasma Facing Materials Based on Spectroscopic Measurement and Monte Carlo Simulation in the Compact PWI Simulator APSEDAS, *19th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* San Diego, May 2010.
487. **Daiji Kato, Takahiro Kenmotsu, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Linear Polarization of Photon Emissions from Reflected Neutrals of Atomic Hydrogen at High-Z First-Wall Surfaces, *19th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* San Diego, May 2010.
488. **H.G. Esser, Andreas Kirschner, D. Borodin, D. Matveev, Kaoru Ohya, O. Schmitz *and* V. Philipps :** Analysis of the Local Redeposition Behaviour of Carbon at the Main Walls in TEXTOR by CD4 Gas Injection and Quartz Microbalance Techniques, *19th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* San Diego, May 2010.
489. **M. Sakamoto, Y. Higashizono, K. Ozaki, K. Ogawa, A. Rusinov, N. Ashikawa, M. Tokitani, T. Shoji, S. Masuzaki, K. Tokunaga, Kaoru Ohya, A. Sagara, N. Yoshida *and* K.N. Sato :** Surface Modification of Tungsten and Its Impact of Deuterium Retention, *19th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* San Diego, May 2010.
490. **Qian Xu, Kaoru Ohya, Z.S. Yang, Kensuke Inai, R.J. Hong *and* G.-N. Luo :** Monte Carlo Simulation of Erosion and Deposition Behavior of SiC-coated Graphite Tiles in EAST, *19th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* San Diego, May 2010.
491. **Andreas Kirschner, A. Kreter, P. Wienhold, S. Brezinsek, A. Pospieszczyk, Ch. Schulz, U. Breuer, D. Borodin, M. Clever, A. Huber, D. Matveev, Kaoru Ohya, V. Philipps, U. Samm, O. Schmitz, B. Schweer, H. Stoschus *and* the TEXTOR Team :** Erosion and Deposition Studies on Plasma-Wetted and -Shadowed Areas by Means of Local Impurity Injection in TEXTOR, *19 th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* San Diego, May 2010.
492. **Niibe Masahito, Maeda Yoshie, Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo *and* Mukai Takashi :** Surface Analysis of n-GaN Crystal Damaged by RF-plasma-etching with Ar, Kr and Xe Gases, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors,* 42, Kagawa, May 2010.
493. **Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo, Niibe Masahito, Mukai Takashi, Takeichi Atsushi *and* Fukudome Toshiaki :** Etch-induced Damage Characteristics of n-GaN Surfaces by Capacitively Coupled Radio Frequency He and Ar Plasmas, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors,* 41, Kagawa, May 2010.
494. **Jin-Ping Ao, Katsutoshi Nakatani, Yuji Sogawa, Young Hyun Kim, Takahiro Miyashita, Shin-ichi Motoyama *and* Yasuo Ohno :** GaN MOSFET with Gate SiO2 Deposited by Silane-Based PECVD, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors,* Takamatsu, May 2010.
495. **Katsushi Nishino, Yuusuke Sawai, Yuji Nariyuki, Takeshi Noda, Yoshiki Naoi, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** TEM Observation of Re-Grown GaN on Nano-Patterned GaN Template, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors,* FrP77, Takamatsu, Jun. 2010.
496. **Retsuo Kawakami, Niibe Masahito, Fukudome Toshiaki, Takeichi Atsushi, Inaoka Takeshi *and* Tominaga Kikuo :** Effect of DBD Air Plasma Treatment on TiO2 Thin Film Surfaces, *The Third International Symposium on Organic and Inorganic Electronic Materials and Related Nanotechnologies (EM-NANO2010),* Toyama, Jun. 2010.
497. **Yoshiki Naoi *and* Yoshifumi Nishio :** Current Challenges of the Double Degree Master Program in Electrical and Electronic Engineering, *Proceedings of the Fifth International Symposium on the Development of the Global Double Degree Program (GDDP),* 15, Tokushima, Aug. 2010.
498. **Fumiya Horie, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** High Temperature Growth of AlxCy by Chemical Vapor Deposition, *The 16th International Conference on Crystal Growth(ICCG-16),* Beijing, Aug. 2010.
499. **Mami Abe, Takahumi Amou, Kenji Kuramoto, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Effects of Substrate Conductivity on Open-Ring Resonator Wireless Interconnection, *2010 Asia-Pacific Radio Science Conference,* Toyama, Sep. 2010.
500. **Jin-Ping Ao, Kensuke Takahashi, Naoki Shinohara, Naoki Niwa, Teruo Fujiwara *and* Yasuo Ohno :** S-parameter Analysis of GaN Schottky Diodes for Microwave Power Rectification, *2010 IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium,* Monterey, Oct. 2010.
501. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Naohide Mohara, Yohei Miyake, Andreas Kirschner, Dimitry Borodin, Doerner Russell, Yoshio Ueda *and* Tetsuo Tanabe :** Molecular Dynamics Study of Plasma Surface Interaction of Codeposited Materials, *23th IAEA Fusion Energy Conference, THD/P3-04,* Daejeon, Oct. 2010.
502. **Masataka Bando, Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Modeling of Impurity Transport in Edge Plasmas and Tritium Codeposition on Plasma Facing Walls in ITER, *9th International Conference on Tritium Science and Technology, 3P07-48,* Nara, Oct. 2010.
503. **Kaoru Ohya *and* Hideaki Kuwada :** Modeling of Electron Beam Charging of an Insulating Layer on Materials, *6th International Workshop on Nano-Scale Spectroscopy & Nanotechnology, P-23, October 25-29, 2010, Kobe Univ., Japan,* Kobe, Oct. 2010.
504. **Jin-Ping Ao :** Monolithic Integration of GaN-based LEDs, *2nd Photonics and Optoelectronics Meetings (POEM2010),* Wuhan, Nov. 2010.
505. **Retsuo Kawakami, Takeichi Atsushi, Niibe Masahito, Inaoka Takeshi *and* Tominaga Kikuo :** Capacitively Coupled Radio Frequency Helium Plasma Etch Damage to TiO2 Thin Film Surfaces, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2010,* 171-172, Tokyo, Nov. 2010.
506. **Masataka Bando *and* Kaoru Ohya :** Modeling of impurity release, transport and deposition on plasma facing components in ITER, *20th International Toki Conference, The Next Twenty Years in Plasma and Fusion Science, December 7-10, Toki, Gifu, Japan, P1-57,* Gifu, Dec. 2010.
507. **Mami Abe, Yuka Okuyama, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Misalignment Effects in Inter-Chip Wireless Connection with Open-Ring Resonators, *2010 Asia-Pacific Microwave Conference (APM C2010),* Yokohama, Dec. 2010.
508. **Yasuo Ohno :** Application of GaN Devices to Wireless Power Transmission, *2010 Asia-Pacific Microwave Conference (APM C2010),* Yokohama, Dec. 2010.
509. **Yohei Miyake *and* Kaoru Ohya :** Molecular dynamics study of plasma wall interactions of W and C containing Be impurity, *20th International Toki Conference, The Next Twenty Years in Plasma and Fusion Science, December 7-10, Toki, Gifu, Japan, P2-77,* Gifu, Dec. 2010.
510. **Hayato Kawazome, Kaoru Ohya *and* Jun Kawata :** Redeposition characteristics of heavy hydrocarbon molecules on a divertor plate, *20th International Toki Conference, The Next Twenty Years in Plasma and Fusion Science, December 7-10, Toki, Gifu, Japan, P2-78,* **Vol.6,** *No.1,* Dec. 2010.
511. **Niibe Masahito, Kotaka Takuya, Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo *and* Mukai Takashi :** Damage Analysis of Plasma-etched n-GaN Crystal Surface by N-K Absorption Spectroscopy, *3rd International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials (ISPlasma2011),* Nagoya, Mar. 2011.
512. **西野 克志 :** 直接合成法によるa面GaNの結晶成長, *LED総合フォーラム,* P20, 2010年4月.
513. **高見 大気, 山中 卓也, 井内 健介, 大宅 薫 :** イオン衝撃による絶縁物の二次電子放出と帯電のシミュレーション, *日本顕微鏡学会第66回学術講演会,* 2010年5月.
514. **日下 一也, 富永 喜久雄 :** 電源の異なる二種類のスパッタリング法で堆積させた2層の窒化アルミニウム薄膜の残留応力測定, *第44回X線材料強度に関するシンポジウム講演論文集,* 105-109, 2010年7月.
515. **大森 悠丘, 丸尾 洋一, 村井 啓一郎, 富永 喜久雄, 森賀 俊広 :** 対向ターゲット式DCスパッタリング装置を用い電流比を変化させて作製したIZO薄膜の特性, *応用物理学会中国四国支部 日本物理学会中国支部・四国支部 日本物理教育学会中国四国支部 2010年度支部学術講演会,* 2010年7月.
516. **阿部 まみ, 敖 金平, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器無線接続における基板抵抗の影響, *第71回応用物理学会学術講演会,* 2010年9月.
517. **原内 健次, 細川 大志, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN横型ショットキーダイオードのSパラメータ解析, *第71回応用物理学会学術講演会,* 2010年9月.
518. **細川 大志, 原内 健次, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN横型ショットキーダイオードの二次元デバイスシミュレーション, *第71回応用物理学会学術講演会,* 2010年9月.
519. **川上 烈生, 新部 正人, 武市 敦, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** GaNの容量結合型RFヘリウムプラズマエッチダメージ, *第71回秋季応用物理学会学術講演会論文集, No.1,* 08-132, 2010年9月.
520. **新部 正人, 前田 佳恵, 川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** Ar, KrおよびXeガスを用いてRFプラズマエッチングしたn-GaN 結晶の表面分析, *第71回秋季応用物理学会学術講演会論文集, No.1,* 08-133, 2010年9月.
521. **原 航平, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** Taマスクを用いたMOCVD再成長GaNの表面モフォロジー改善, *第71回応用物理学会学術講演会,* 15p-C-8, 2010年9月.
522. **堀江 郁哉, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** MOCVD法によるAlC薄膜の成長, *第71回応用物理学会学術講演会,* 16a-ZT-11, 2010年9月.
523. **川上 烈生, 新部 正人, 武市 敦, 稲岡 武, 小西 将士, 森 祐太, 兒玉 宗久, 富永 喜久雄 :** TiO2光触媒へのDBDエアプラズマトリートメント効果, *平成22年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 20, 2010年9月.
524. **武市 敦, 川上 烈生, 新部 正人, 稲岡 武, 向井 考志, 小西 将士, 森 祐太, 兒玉 宗久, 富永 喜久雄 :** ヘリウムとアルゴンプラズマによる窒化ガリウムエッチングダメージ, *平成22年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 21, 2010年9月.
525. **川崎 晃一, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** MOCVD法によるSiおよびサファイア上へのGeC薄膜の成長, *平成22年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-2, 2010年9月.
526. **松本 将和, 福田 弘之, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** GaN系UV-LEDの偏光特性, *平成22年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-14, 2010年9月.
527. **楠 貴大, 沼島 明菜, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** ナノ微粒子技術を用いたGaN表面周期構造の作製, *平成22年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-17, 2010年9月.
528. **和田 祥吾, 直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** 金属マスクを施したサファイア表面周期構造へのGaN成長と評価, *平成22年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-18, 2010年9月.
529. **加藤 保洋, 中内 潤, 西野 克志, 月原 政志, 酒井 士郎 :** 昇華法によるバルクAlNの成長, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* 11-3, 2010年9月.
530. **高見 大気, 山中 卓也, 大宅 薫 :** イオンビーム照射による絶縁物薄膜の帯電と二次電子放出のシミュレーション, *第30回LSIテスティングシンポジウム会議録,* 41-46, 2010年11月.
531. **大宅 薫 :** ベリリウム堆積によるITERダイバータにおける損耗・再堆積のシミュレーション, *平成22年 PWI合同研究会(核融合科学研究所),* 2010年11月.
532. **大宅 薫, 三宅 洋平 :** ベリリウム混合層におけるプラズマ・壁相互作用の分子動力学シミュレーション, *第27回プラズマ・核融合学会年会，札幌，2010年11月30日∼12月3日，30P56,* 2010年11月.
533. **Kirschner Andreas, 大宅 薫, Borodin D., Matveev D., Galonska A., Brezinsek Sebastian, Esser H.G., Kreter A., Litnovsky A., Philipps V., Samm U., Wienhold P., Kawamura G., Tanabe T., Ueda Y. :** Simulation of material migration in tokamaks, *第27回プラズマ・核融合学会年会，札幌，2010年11月30日∼12月3日，02pB02,* 2010年12月.
534. **新部 正人, 小高 拓也, 川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** プラズマエッチングしたGaN結晶のN-K吸収測定によるダメージ解析II, *第24回日本放射光学会年会,* 2011年1月.
535. **原内 健次, 岩崎 裕一, 阿部 まみ, 敖 金平, 篠原 真毅, 外村 博史, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器接続によるマイクロ波無線電力伝送, *2011年電子情報通信学会総合大会,* 2011年3月.
536. **細川 大志, 黒田 健太郎, 井谷 祥之, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET 電流コラプスの回復過程測定, *第57回応用物理学関係連合講演会,* 2011年3月.
537. **中野 由崇, 川上 烈生, 新部 正人, 武市 敦, 稲岡 武, 富永 喜久雄 :** GaN のプラズマエッチング損傷のフォトルミネッセンス評価, *第58回春季応用物理学会学術講演会, No.1,* 2011年3月.
538. **松本 将和, 福田 弘之, 直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** 表面・界面に周期構造を有するGaN系LEDの配向特性評価, *LED総合フォーラム,* 69, 2010年4月.
539. **川上 烈生, 福留 利章, 武市 敦, 稲岡 武, 富永 喜久雄 :** UV-LED光触媒反応によるクライマクテリック型果実の汎用型鮮度維持技術の開発研究, *LED総合フォーラム2010 in 徳島,* 89-92, 2010年4月.
540. **川上 烈生 :** LED光触媒酸化作用を用いた果実の汎用型鮮度保持技術の開発研究, *四国まるごと「食と健康」イノベーション2010∼四国の研究機関が集い「食と健康」リソースを発信∼,* 2010年8月.
541. **川上 烈生 :** 果実の汎用型鮮度維持装置(JST成果の一部としてLED光触媒装置の出展参加), *徳島ビジネスチャレンジメッセ2010,* 2010年10月.
542. **新部 正人, 小高 拓也, 川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** 希ガスプラズマでエッチングしたn-GaN結晶のNEXAFS測定によるダメージ解析, *2011先端技術セミナー，高度産業科学技術研究所主催,* 65, 2011年3月.
543. **川上 烈生 :** 高周波キセノンプラズマによる自己無撞着な衝撃粒子エネルギー分布及び粒子束の解析, *平成22年度核融合科学研究所LHD数値解析システム利用共同研究報告書,* 日本, 2011年3月.
544. **川上 烈生 :** プラズマイオンと紫外光線のシナジー効果によるワイドギャップ半導体エッチングダメージの振舞い, *平成22年度先端工学教育研究プロジェクト,* 日本, 2011年3月.
545. **一樂 浩之, 笠谷 武司, 田中 義浩, 衣斐 八束, 福井 明, 川上 烈生, 稲岡 武 :** 果実殺菌のための紫外線/ラジカルジェットデバイスの開発研究, *財団法人 阿波銀行学術・文化振興財団,平成22年度(第15回)学術部門助成(地域共同研究助成,* 日本, 2011年3月.